

Предметный указатель

Содержание

1.	Персоналии	1515
2.	Обзоры	1515
3.	Электромагнетизм, оптика, акустика (PACS 40)	1515
3.1.	Полупроводниковые лазеры (PACS 42.55.Px)	1516
4.	Структура, механические и термические свойства (PACS 60)	1516
4.1.	Структура, кристаллография (PACS 61)	1516
4.1.1.	Исследование структуры полупроводников (PACS 61.10-61.16)	1517
4.1.2.	Аморфные, стеклообразные полупроводники (PACS 61.43)	1517
4.1.3.	Кластеры и наночастицы (PACS 61.46)	1517
4.1.4.	Дефекты в кристаллах (PACS 61.72)	1517
4.1.5.	Физические эффекты, связанные с облучением. Радиационные дефекты (PACS 61.80)	1518
4.2.	Механические и акустические свойства (PACS 62). Динамика решетки (PACS 63)	1519
4.3.	Фазовые равновесия и фазовые переходы (PACS 64)	1519
4.4.	Термические свойства (PACS 65). Диффузия и теплопроводность (PACS 66)	1519
4.5.	Структура поверхностей, границ раздела и тонких пленок (PACS 68)	1519
5.	Электронная структура, электрические, магнитные и оптические свойства (PACS 70)	1520
5.1.	Электронные состояния (PACS 71)	1520
5.1.1.	Уровни дефектов и примесей (PACS 71.55)	1521
5.2.	Транспортные явления (PACS 72)	1521
5.2.1.	Явления электронной проводимости в полупроводниках (PACS 72.20)	1522
5.2.2.	Высокочастотные эффекты и эффекты обусловленные плазмой (PACS 72.30)	1523
5.2.3.	Фотопроводимость и фотовольтаический эффект (PACS 72.40)	1523
5.2.4.	Шумы (PACS 72.70)	1523
5.3.	Электронная структура и электрические свойства поверхностей, границ раздела и тонких пленок (PACS 73)	1523
5.3.1.	Электронные состояния на поверхностях и границах раздела (PACS 73.20)	1525
5.3.2.	Барьеры Шоттки (PACS 73.30)	1525
5.3.3.	Транспортные явления в структурах, содержащих границы раздела (PACS 73.40)	1526
5.3.4.	Транспортные явления в тонких пленках (PACS 73.50)	1527
5.4.	Сверхпроводимость (PACS 74). Магнитные свойства (PACS 75), магнитные резонансы (PACS 76)	1527
5.5.	Диэлектрические и пьезоэлектрические свойства (PACS 77)	1527
5.6.	Оптические свойства полупроводников, спектроскопия, взаимодействие с различными видами излучений (PACS 78)	1528
5.6.1.	Оптические свойства объемных материалов (PACS 78.20)	1529

5.6.2.	Инфракрасная спектроскопия, комбинационное рассеяние (PACS 78.30)	1529
5.6.3.	Люминесценция, излучательная рекомбинация (PACS 78.55; 78.60)	1530
5.6.4.	Оптические свойства тонких пленок, поверхностей и структур, содержащих границы раздела (сверхрешетки, гетеропереходы и т.п.) (PACS 78.66)	1531
5.7.	Эмиссия электронов и ионов. Ударная ионизация (PACS 79)	1531
6.	Технология, материаловедение, применение полупроводников (PACS 80)	1531
6.1.	Методы получения и обработки полупроводниковых материалов (PACS 81; 82)	1531
6.2.	Полупроводниковые приборы (PACS 84; 85)	1533

1. Персоналии

Эммануил Ильич Адирович (к 30-летию со дня смерти)	1	128
Виталий Иванович Стафеев (к 75-летию со дня рождения)	2	249
Ия Павловна Ипатова	4	512

2. Обзоры

Теория пороговых характеристик полупроводниковых лазеров на квантовых точках. Л.В. Асрян, Р.А. Сурис	1	3
Радиационная стойкость SiC и детекторы жестких излучений на его основе. А.А. Лебедев, А.М. Иванов, Н.Б. Строкан	2	129
Магнитные свойства углеродных структур. Т.Л. Макарова	6	641
Электронные и колебательные состояния InN и твердых растворов In_xGa_{1-x}N. В.Ю. Давыдов, А.А. Клочихин	8	897
Светочувствительные полимерные полупроводники. Е.Л. Александрова	10	1153

3. Электромагнетизм, оптика, акустика (PACS 40)

Теория пороговых характеристик полупроводниковых лазеров на квантовых точках. Л.В. Асрян, Р.А. Сурис	1	3
Сине-зеленое излучение в полупроводниковых лазерах с квантовыми ямами на основе GaAs. Н.В. Байдуш, А.А. Бирюков, Б.Н. Звонков, С.М. Некоркин, В.Я. Алешкин	3	366
Нелинейное поглощение света в твердых растворах Zn_{0.37}Cd_{0.63}Se. А. Байдуллаева, А.И. Власенко, П.Е. Мозоль, Л.Ф. Щербонос	5	529
Тенденции и перспективы развития солнечной фотоэнергетики. Ж.И. Алфёров, В.М. Андреев, В.Д. Румянцев	8	937

- Key aspects in the modeling of concentrator III–V solar cells and III–V thermophotovoltaic converters. Carlos Algora 8 958
- Next-Generation Technologies in the USA. R. McConnell 8 971
- Practical thermophotovoltaic generators. B. Bitnar, W. Durisch, G. Palfinger, F. von Roth, U. Vogt, A. Brönstrup, D. Seiler 8 980
- Intermediate band solar cells: comparison with Shockley–Read–Hall recombination. A. Martí, L. Cuadra, N. López, A. Luque 8 985
- Термофотоэлектрические преобразователи теплового и концентрированного солнечного излучения. В.П. Хвостиков, О.А. Хвостикова, П.Ю. Газарян, М.З. Шварц, В.Д. Румянцев, В.М. Андреев 8 988
- Japan programs on novel concepts in PV. Masafumi Yamaguchi, Tatsuya Takamoto, Kenji Araki, Mitsuru Imaizumi 8 994
- Технология создания рисунка в макропористом кремнии и получение полос двумерных фотонных кристаллов с вертикальными стенками. Е.В. Астрова, Т.Н. Боровинская, В.А. Толмачев, Т.С. Перова . . 9 1125
- Светочувствительные свойства тонких полупроводниковых пленок наноккомпозитов на основе металлорганических комплексов Cu^+ и Ru^{2+} . Е.Л. Александрова, Н.Н. Химич 11 1321
- Механизм фотогенерации носителей заряда в полиамидиновых супрамолекулярных структурах. Е.Л. Александрова, М.М. Дудкина, А.В. Теньковцев 11 1325
- Люминесцентные свойства ZnO -микрорезонаторов цилиндрической формы. А.Н. Грузинцев, В.Т. Волков, С.В. Дубонос, М.А. Князев, Е.Е. Якимов 12 1473
- 3.1. Полупроводниковые лазеры (PACS 42.55.Px)**
- Нелинейная генерация дальнего инфракрасного излучения в двухчастотных полупроводниковых лазерах. А.А. Афоненко, В.Я. Алешкин, А.А. Дубинов 2 244
- Внутренние оптические потери в полупроводниковых лазерах. Н.А. Пихтин, С.О. Слипченко, З.Н. Соколова, И.С. Тарасов 3 374
- Низкопороговые инжекционные лазеры на основе одиночных квантовых ям InGaAsN , работающие в диапазоне длин волн 1.3 мкм. В.А. Одноблюдов, А.Ю. Егоров, М.М. Кулагина, Н.А. Малеев, Ю.М. Шерняков, Е.В. Никитина, В.М. Устинов . . . 5 630
- Температурные электролюминесцентные исследования излучательных характеристик инжекционных лазеров на основе InGaAsN/GaAs . Л.Я. Карачинский, Н.Ю. Гордеев, И.И. Новиков, М.В. Максимов, А.Р. Ковш, J.S. Wang, R.S. Hsiao, J.Y. Chi, В.М. Устинов, Н.Н. Леденцов 6 757
- Мощные лазеры на квантовых точках InAs-InGaAs спектрального диапазона 1.5 мкм, выращенные на подложках GaAs . М.В. Максимов, Ю.М. Шерняков, Н.В. Крыжановская, А.Г. Гладышев, Ю.Г. Мусихин, Н.Н. Леденцов, А.Е. Жуков, А.П. Васильев, А.Р. Ковш, С.С. Михрин, Е.С. Семенова, Н.А. Малеев, Е.В. Никитина, В.М. Устинов, Ж.И. Алфёров 6 763
- Лазерная генерация в гетероструктурах Cd(Zn)Se/ZnMgSSe при накачке излучением азотного и InGaN/GaN лазеров. И.В. Седова, С.В. Сорокин, А.А. Торопов, В.А. Кайгородов, С.В. Иванов, П.С. Копьев, Е.В. Луценко, В.Н. Павловский, В.З. Зубелевич, А.Л. Гурский, Г.П. Яблонский, Y. Dikme, H. Kalisch, A. Szymakowski, R.H. Jansen, B. Schineller, M. Heuken 9 1135
- Нелинейное преобразование частоты в лазере с двойным вертикальным резонатором. Ю.А. Морозов, И.С. Нефедов, В.Я. Алешкин 11 1392
- Сверхнизкие внутренние оптические потери в квантово-размерных лазерных гетероструктурах раздельного ограничения. С.О. Слипченко, Д.А. Винокуров, Н.А. Пихтин, З.Н. Соколова, А.Л. Станкевич, И.С. Тарасов, Ж.И. Алфёров 12 1477
- 4. Структура, механические и термические свойства (PACS 60)**
- 4.1. Структура, кристаллография (PACS 61)**
- Получение гетероструктур окисел– $p\text{-InSe}$ с улучшенными фотоэлектрическими характеристиками. В.Н. Катеринчук, З.Д. Ковалок 4 417
- Магнитные свойства углеродных структур. Т.Л. Макарова 6 641
- Устойчивость обработанных протонами GaAs фотодетекторов к гамма-нейтронному облучению. А.В. Мурель, С.В. Оболенский, А.Г. Фефелов, Е.В. Киселева 7 834
- Взаимодействие молекул C_{60} с поверхностью $(100)\text{W}$ — адсорбция, начальные стадии роста пленок и термическая трансформация адсорбционного слоя. Н.Р. Галль, Е.В. Рутьков, А.Я. Тонтегоде 9 1061
- Поведение варизонных детекторов ионизирующих излучений при облучении α -частицами. Л. Дапкус, К. Пожела, Ю. Пожела, А. Шилленас, В. Юcene, В. Ясутис 9 1147
- Формирование и исследование захороненных слоев SiC с высоким содержанием радиационных дефектов. Е.В. Богданова, В.В. Козловский, Д.С. Румянцев, А.А. Волкова, А.А. Лебедев 10 1211
- Оптические и электрические свойства 4H-SiC , облученного нейтронами и тяжелыми ионами высоких энергий. Е.В. Калинина, Г.Ф. Холуянов, Г.А. Онушкин, Д.В. Давыдов, А.М. Стрельчук, А.О. Константинов, А. Hallén, А.Ю. Никифоров, В.А. Скуратов, K. Havancsak 10 1223
- Твердые растворы $(\text{C}_2^{\text{IV}})_{1-x}(\text{A}^{\text{III}}\text{B}^{\text{V}})_x$, полученные из ограниченного объема оловянного раствора–расплава. Б. Сапаев, М.С. Саидов, А.С. Саидов, С.Ж. Каражанов 11 1285
- Влияние протонного облучения на кинетику затухания фосфоресценции керамики ZnS-Cu . Т.А. Кучакова, Г.В. Весна, В.А. Макара 11 1316

4.1.1. Исследование структуры полупроводников (PACS 61.10-61.16)

АСМ визуализация нанокристаллов Si в термическом окисле SiO₂ с помощью селективного травления. М.С. Дунаевский, J.J. Grob, А.Г. Забродский, R. Laiho, А.Н. Титков 11 1294

4.1.2. Аморфные, стеклообразные полупроводники (PACS 61.43)

Diffusion of Chromium in Thin Hydrogenated Amorphous Silicon Films. S.K. Persheyev, P.R. Drapacz, M.J. Rose, A.G. Fitzgerald 3 358

Взаимодействие инфракрасного излучения со свободными носителями заряда в мезопористом кремнии. Л.А. Осминкина, Е.В. Курепина, А.В. Павликов, В.Ю. Тимошенко, П.К. Кашкаров 5 603

Формирование толстых слоев пористого кремния при недостаточной концентрации неосновных носителей. Д.Н. Горячев, Л.В. Беляков, О.М. Сресели 6 739

Некоторые особенности диффузии Ga в порошках ZnS. Ю.Ю. Бачериков, И.П. Ворона, С.В. Оптасюк, В.Е. Родионов, А.А. Стадник 9 1025

Влияние протонного облучения на кинетику затухания фосфоресценции керамики ZnS—Cu. Т.А. Кучакова, Г.В. Весна, В.А. Макара 11 1316

Распределение по размерам нанокластеров кобальта в матрице аморфного углерода. В.И. Иванов-Омский, А.В. Колобов, А.Б. Лодыгин, С.Г. Ястребов 12 1463

4.1.3. Кластеры и наночастицы (PACS 61.46)

Формирование пленок нанокристаллического кремния имплантацией больших доз ионов Н⁺ в слои кремния на изоляторе и последующим быстрым термическим отжигом. И.Е. Тыщенко, В.П. Попов, А.Б. Талочкин, А.К. Гутаковский, К.С. Журавлев . . 1 111

Исследование образования и модификации нанокристаллических включений кремния в пленках a-Si:H методом просвечивающей электронной микроскопии. В.П. Афанасьев, А.С. Гудовских, А.З. Казак-Казакевич, А.П. Сазанов, И.Н. Трапезникова, Е.И. Теруков 2 226

Электротранспортные процессы в монокристаллах антимонида галлия с участием расплавленных включений GaSb—Sn. А.М. Орлов, А.А. Скворцов, А.А. Саланов 4 391

Геометрическая структура и спектральные характеристики электронных состояний кремниевых наночастиц. С.И. Курганский, Н.А. Борщ 5 580

Исследования методом электронного парамагнитного резонанса пленок нанокристаллического кремния, полученных импульсным лазерным осаждением. В.Я. Братусь, С.М. Окулов, Э.Б. Каганович, И.М. Кизяк, Э.Г. Манойлов 5 621

Нелинейные свойства фототропных сред на основе наночастиц селенидов меди Cu_xSe в кварцевом стекле. С.А. Золотовская, Н.Н. Поснов, П.В. Прокошин, К.В. Юмашев, В.С. Гурин, А.А. Алексеенко 7 846

Излучательная рекомбинация в пленках SiO₂, имплантированных ионами Ge⁺ и отожженных в условиях гидростатического сжатия. И.Е. Тыщенко, Л. Реболе 7 852

О возможностях подавления формирования dome-кластеров при молекулярно-пучковой эпитаксии Ge на Si(100). А.А. Тонких, Г.Э. Цырлин, В.Г. Дубровский, В.М. Устинов, P. Werner 10 1239

АСМ визуализация нанокристаллов Si в термическом окисле SiO₂ с помощью селективного травления. М.С. Дунаевский, J.J. Grob, А.Г. Забродский, R. Laiho, А.Н. Титков 11 1294

Распределение по размерам нанокластеров кобальта в матрице аморфного углерода. В.И. Иванов-Омский, А.В. Колобов, А.Б. Лодыгин, С.Г. Ястребов 12 1463

4.1.4. Дефекты в кристаллах (PACS 61.72)

Зеленая полоса люминесценции пленок оксида цинка, легированных медью в процессе термической диффузии. Я.И. Ализов, М.В. Чукичев, В.А. Никитенко 1 34

Влияние примесей на излучательную рекомбинацию через центры EL2 в монокристаллах арсенида галлия. М.Б. Литвинова 1 44

Формирование пленок нанокристаллического кремния имплантацией больших доз ионов Н⁺ в слои кремния на изоляторе и последующим быстрым термическим отжигом. И.Е. Тыщенко, В.П. Попов, А.Б. Талочкин, А.К. Гутаковский, К.С. Журавлев . . 1 111

Исследование образования и модификации нанокристаллических включений кремния в пленках a-Si:H методом просвечивающей электронной микроскопии. В.П. Афанасьев, А.С. Гудовских, А.З. Казак-Казакевич, А.П. Сазанов, И.Н. Трапезникова, Е.И. Теруков 2 226

Генезис наноразмерных дефектов и разрушений в GaAs при многократном квазистатическом фотодеформировании микронных областей полупроводника. С.В. Винценц, А.В. Зайцева, В.Б. Зайцев, Г.С. Плотников 3 257

Определение концентрации галлия в германии, трансмутационно легированном нейтронами, из измерений сопротивления в области прыжковой проводимости. О.П. Ермолаев, Т.Ю. Миккульчик . . 3 285

Импеданс твердых растворов на основе теллурида свинца, легированного галлием. Б.А. Акимов, В.В. Прядун, Л.И. Рябова, Д.Р. Хохлов 3 293

Магнитные исследования широкозонных полупроводников Cd_{1-x}Zn_xTe (x = 0.12, 0.21). Ю.В. Шалдин, И. Вархульска, М.Х. Рабаданов, В.К. Комарь 3 300

Низкотемпературная релаксация упругих напряжений в SiGe/Si-гетероструктурах, облученных ионами Ge⁺. В.С. Аврутин, Ю.А. Агафонов, А.Ф. Вяткин, В.И. Зиненко, Н.Ф. Изюмская, Д.В. Иржак, Д.В. Рошупкин, Э.А. Штейнман, В.И. Вдовин, Т.Г. Югова 3 325

- Закономерности влияния примесей на предел текучести кристаллов кремния. *Б.В. Петухов* 4 385
- Модель фотоотжига собственных дефектов гексагональных квантовых точек CdS_xSe_{1-x} . *В.П. Кунец, Н.Р. Кулиш, М.П. Лисица, В.П. Брыкса* 4 465
- Зависимость температуры отжига диулерода в облученном n -Si от концентрации кислорода в кристалле. *Н.И. Бояркина, С.А. Смагулова* 5 513
- Равновесные характеристики и низкотемпературная фотолуминесценция монокристаллов $CdTe:Pb$. *А.В. Савицкий, О.А. Парфенюк, М.И. Илащук, А.Й. Савчук, С.Н. Чупыра* 5 516
- Исследование рекомбинационных центров в облученных кристаллах p -Si. *Т.А. Пагава* 6 665
- Формирование электрически активных центров в кремнии, облученном электронами, в интервале температур $400-700^\circ C$. *Е.П. Неустроев, С.А. Смагулова, И.В. Антонова, Л.Н. Сафронов* 7 791
- Электрофизические свойства и предельное положение уровня Ферми в $InSb$, облученном протонами. *В.Н. Брудный, В.М. Бойко, И.В. Каменская, Н.Г. Колин* 7 802
- Аномальная растворимость имплантированного азота в кремнии, сильно легированном бором. *Д.И. Тетельбаум, Е.И. Зорин, Н.В. Лисенкова* 7 808
- Пьезоспектроскопическое исследование полосы излучения с максимумом около 1.2 эВ в n -GaAs:S. *А.А. Гуткин, М.А. Решиков* 7 825
- Влияние вакуумного отжига на краевую люминесценцию нелегированного селенида цинка. *В.П. Махний, А.М. Слетов, И.В. Ткаченко* 9 1034
- Модель электрической изоляции GaN и ZnO при бомбардировке легкими ионами. *А.И. Титов, П.А. Карасев, С.О. Кучеев* 10 1215
- Влияние давления и водорода на образование вакансий и дивакансий в кристаллическом кремнии. *В.Г. Заводинский, А.А. Гниденко, А. Мисюк, Я. Бак-Мисюк* 11 1281
- К эффекту больших доз при ионной имплантации кремния. *Д.И. Тетельбаум, А.И. Герасимов* 11 1301
- Ловушки с энергиями вблизи середины запрещенной зоны на границе Si/SiO₂, созданной сращиванием, в структурах кремний-на-изоляторе. *И.В. Антонова, В.П. Попов, В.И. Поляков, А.И. Руквишников* . . . 12 1439
- 4.1.5. Физические эффекты, связанные с облучением. Радиационные дефекты (PACS 61.80)**
- Динамика развития поверхностных структур в кристаллах p -CdTe при облучении импульсным лазерным излучением. *А. Байдуллаева, М.Б. Булах, А.И. Власенко, А.В. Ломовцев, П.Е. Мозоль* 1 26
- Формирование омических контактов к полупроводящему GaAs путем лазерного осаждения In. *В. Казлаускене, В. Кажукаускас, Ю. Мишкинис, А. Петравичюс, Р. Пурас, С. Сакалаускас, Ю. Синюс, Ю.-В. Вайткус, А. Жиндулис* 1 79
- Формирование пленок нанокристаллического кремния имплантацией больших доз ионов H^+ в слои кремния на изоляторе и последующим быстрым термическим отжигом. *И.Е. Тысченко, В.П. Попов, А.Б. Талочкин, А.К. Гутаковский, К.С. Журавлев* . . 1 111
- Радиационная стойкость SiC и детекторы жестких излучений на его основе Обзор. *А.А. Лебедев, А.М. Иванов, Н.Б. Строкан* 2 129
- Определение концентрации галлия в германии, трансмутационно легированном нейтронами, из измерений сопротивления в области прыжковой проводимости. *О.П. Ермолаев, Т.Ю. Микунчик* . . 3 285
- Исследование рекомбинационных центров в облученных кристаллах p -Si. *Т.А. Пагава* 6 665
- Исследование физических механизмов лазерной коррекции и стабилизации параметров структур $Al-n-n^+-Si-Al$ с барьером Шоттки. *Г.И. Воробец, М.М. Воробец, В.Н. Стребежев, Е.В. Бузанева, А.Г. Шкавро* 6 690
- Стимулирование металлургических реакций на интерфейсе Ni-SiC протонным облучением. *В.В. Козловский, П.А. Иванов, Д.С. Румянцев, В.Н. Ломасов, Т.П. Самсонова* 7 778
- Формирование электрически активных центров в кремнии, облученном электронами, в интервале температур $400-700^\circ C$. *Е.П. Неустроев, С.А. Смагулова, И.В. Антонова, Л.Н. Сафронов* 7 791
- Электрофизические свойства и предельное положение уровня Ферми в $InSb$, облученном протонами. *В.Н. Брудный, В.М. Бойко, И.В. Каменская, Н.Г. Колин* 7 802
- Устойчивость обработанных протонами GaAs фотодетекторов к гамма-нейтронному облучению. *А.В. Мурель, С.В. Оболенский, А.Г. Фефелов, Е.В. Киселева* 7 834
- Исследование собирания носителей в CdZnTe-детекторах рентгеновского и γ -излучения фотоэлектрическим методом. *Л.А. Косяченко, Е.Л. Масляничук, И.М. Раренко, В.М. Склярчук* 8 1018
- Особенности отжига радиационных дефектов в кремниевых $p-n$ -структурах: роль примесных атомов железа. *Б.А. Комаров* 9 1079
- Формирование и исследование захороненных слоев SiC с высоким содержанием радиационных дефектов. *Е.В. Богданова, В.В. Козловский, Д.С. Румянцев, А.А. Волкова, А.А. Лебедев* 10 1211
- Модель электрической изоляции GaN и ZnO при бомбардировке легкими ионами. *А.И. Титов, П.А. Карасев, С.О. Кучеев* 10 1215
- Оптические и электрические свойства $4H$ -SiC, облученного нейтронами и тяжелыми ионами высоких энергий. *Е.В. Калинина, Г.Ф. Холуянов, Г.А. Онушкин, Д.В. Давыдов, А.М. Стрельчук, А.О. Константинов, А. Hallén, А.Ю. Никифоров, В.А. Скуратов, К. Havancsak* 10 1223
- Влияние γ -облучения на характеристики границы раздела кремний-свинцово-боросиликатное стекло. *П.Б. Парчинский, С.И. Власов, А.А. Насиров* 11 1345

Кинетика роста поверхностного аморфного слоя при низкотемпературном облучении кремния быстрыми тяжелыми ионами. А.Ю. Азаров	12	1445
4.2. Механические и акустические свойства (PACS 62). Динамика решетки (PACS 63)		
Роль сплавных эффектов в формировании электронной структуры неупорядоченных твердых растворов III-нитридов. А.В. Возный, В.Г. Дейбук	3	316
Закономерности влияния примесей на предел текучести кристаллов кремния. Б.В. Петухов	4	385
Плазмон-фонон-поляритоны в легированных акцепторной примесью сплавах висмут—сурьма. Н.П. Степанов	5	552
Свойства самоорганизованных SiGe-наноструктур, полученных методом ионной имплантации. Ю.Н. Пархоменко, А.И. Белогорохов, Н.Н. Герасименко, А.В. Иржак, М.Г. Лисаченко	5	593
Межфазные взаимодействия и особенности структурной релаксации в контактах $TiB_x-n-GaAs$ (InP, GaP, 6H-SiC), подвергнутых активным обработкам. Н.С. Болтовец, В.Н. Иванов, Р.В. Конакова, Я.Я. Кудрик, О.С. Литвин, П.М. Литвин, В.В. Миленин	7	769
4.3. Фазовые равновесия и фазовые переходы (PACS 64)		
Явление гистерезиса в Ag_2Te вблизи и в области фазового превращения. С.А. Алиев	7	830
Твердые растворы $(C_2^{IV})_{1-x}(A^{III}B^V)_x$, полученные из ограниченного объема оловянного раствора—расплава. Б. Сапаев, М.С. Саидов, А.С. Саидов, С.Ж. Каражанов	11	1285
Колебательные моды и электронно-фононное взаимодействие в полупроводниковых нанотрубках. А.И. Ведерников, А.В. Чаплик	11	1358
4.4. Термические свойства (PACS 65). Диффузия и теплопроводность (PACS 66)		
Влияние предварительного легирования и режимов имплантации на диффузию кремния в GaAs при радиационном отжиге. М.В. Ардышев, В.М. Ардышев, Ю.Ю. Крючков	3	265
Моделирование концентрационной зависимости диффузии бора в кремнии. О.В. Александров	3	270
Диффузия хрома в арсениде галлия. С.С. Хлудков, О.Б. Корецкая, А.В. Тяжев	3	274
Роль сплавных эффектов в формировании электронной структуры неупорядоченных твердых растворов III-нитридов. А.В. Возный, В.Г. Дейбук	3	316
Зависимость температуры отжига диуглерода в облученном $n-Si$ от концентрации кислорода в кристалле. Н.И. Бояркина, С.А. Смагулова	5	513

Аномальная растворимость имплантированного азота в кремнии, сильно легированном бором. Д.И. Тельбаум, Е.И. Зорин, Н.В. Лисенкова	7	808
Некоторые особенности диффузии Ga в порошках ZnS. Ю.Ю. Бачериков, И.П. Ворона, С.В. Опгасюк, В.Е. Родионов, А.А. Стадник	9	1025
Определение профиля диффузии кислорода в поликристаллических слоях селенида свинца методами ядерного микроанализа. А.Е. Гамарц, В.М. Лебедев, В.А. Мошников, Д.Б. Чеснокова	10	1195
Влияние термоэлектрического поля на вольт-амперную характеристику гетероперехода $p-Ge-n-GaAs$. М.М. Гаджиалнев, З.Ш. Пирмагомедов, Т.Н. Эфендиева	11	1343
4.5. Структура поверхностей, границ раздела и тонких пленок (PACS 68)		
Динамика развития поверхностных структур в кристаллах $p-CdTe$ при облучении импульсным лазерным излучением. А. Байдуллаева, М.Б. Булах, А.И. Власенко, А.В. Ломовцев, П.Е. Мозоль	1	26
Преобразование центров люминесценции CVD-ZnS при газостатировании. Н.К. Морозова, И.А. Каретников, В.Г. Плотниченко, Е.М. Гавришук, Э.В. Яшина, В.Б. Иконников	1	39
Исследование структурного совершенства эпитаксиальных слоев $Cd, Hg_{1-x}Te/CdZnTe$ методом комбинационного рассеяния света. А.И. Белогорохов, И.А. Денисов, Н.А. Смирнова, Л.И. Белогорохова	1	84
Простая модель для расчета скорости роста эпитаксиальных слоев карбида кремния в вакууме. С.Ю. Давыдов, А.А. Лебедев, Н.С. Савкина, М. Syvajarvi, R. Yakimova	2	153
Адсорбция сольватированных гидросульфид-ионов на поверхность GaAs(100): роль растворителя при модификации структуры поверхности. М.В. Лебедев, Th. Mayer, W. Jaegermann	2	156
Влияние содержания In и Al на характеристики собственных дефектов в квантовых точках на основе арсенида галлия. Т.В. Безъязычная, В.М. Зеленковский, Г.И. Рябцев, М.М. Соболев	2	213
Фоточувствительность структур с квантовыми ямами, выращенных методом МОС-гидридной эпитаксии, при нормальном падении излучения. В.Б. Куликов, Г.Х. Аветисян, Л.М. Василевская, И.Д. Залевский, И.В. Будкин, А.А. Падалица	2	218
Исследование образования и модификации нанокристаллических включений кремния в пленках $a-Si:H$ методом просвечивающей электронной микроскопии. В.П. Афанасьев, А.С. Гудовских, А.З. Казак-Казакевич, А.П. Сазанов, И.Н. Трапезникова, Е.И. Теруков	2	226
Особенности встраивания молекул Sb_2 и Sb_4 при молекулярно-пучковой эпитаксии твердых растворов AlGaAsSb. А.Н. Семенов, В.С. Сорокин, В.А. Соловьев, Б.Я. Мельцер, С.В. Иванов	3	278

- Зависимость структурных и оптических свойств ансамблей квантовых точек в системе InAs/GaAs от температуры поверхности и скорости роста.** В.Г. Дубровский, Ю.Г. Мусихин, Г.Э. Цырлин, В.А. Егоров, Н.К. Поляков, Ю.Б. Самсоенко, А.А. Тонких, Н.В. Крыжановская, Н.А. Берт, В.М. Устинов 3 342
- Структурные и оптические свойства гетероструктур с квантовыми точками InAs в квантовой яме InGaAsN, выращенных методом молекулярно-пучковой эпитаксии.** И.П. Сошников, Н.В. Крыжановская, Н.Н. Леденцов, А.Ю. Егоров, В.В. Мамутин, В.А. Одноблюдов, В.М. Устинов, О.М. Горбенко, Н. Kirmse, W. Neumann, D. Bimberg 3 354
- Модель фотоотжига собственных дефектов гексагональных квантовых точек CdS_xSe_{1-x}.** В.П. Кунец, Н.Р. Кулиш, М.П. Лисица, В.П. Брыкса 4 465
- Исследование характеристик фотодиодных линеек на InSb.** П.В. Бирюлин, В.И. Туринов, Е.Б. Якимов 4 498
- Взаимосвязь спиновых структурных дефектов и проводимости в пленках гидрированного нанокристаллического кремния с добавками углерода.** О.И. Шевалесевский, А.А. Цветков, Л.Л. Ларина, S.Y. Myong, K.S. Lim 5 547
- Изменение контактной разности потенциалов фотодиода на основе гетероперехода n-InSe-p-GaSe в процессе „старения“.** С.И. Драпак, В.Б. Орлецкий, З.Д. Ковалюк 5 566
- Особенности получения и некоторые свойства гетероперехода n-ZnO:Ga/p-GaN:Mg/α-Al₂O₃.** Б.М. Атаев, Я.И. Ализов, В.В. Мамедов, С.Ш. Махмудов, Б.А. Магомедов 6 699
- Выращивание эпитаксиальных слоев AlGaIn и сверхрешеток AlGaIn/GaN методом газовой фазной эпитаксии из металлоорганических соединений.** В.В. Лундин, А.В. Сахаров, А.Ф. Цацульников, Е.Е. Заварин, А.И. Бесюлькин, А.В. Фомин, Д.С. Сизов 6 705
- Электрон-электронное рассеяние в ступенчатых квантовых ямах.** В.Л. Зерова, Л.Е. Воробьев, Г.Г. Зегря 6 716
- Спектроскопия экситонных состояний квантовых молекул InAs.** В.Г. Талалаев, J.W. Tomm, N.D. Zakharov, P. Werner, Б.В. Новиков, Г.Э. Цырлин, Ю.Б. Самсоенко, А.А. Тонких, В.А. Егоров, Н.К. Поляков, В.М. Устинов 6 723
- Стимулирование металлургических реакций на интерфейсе Ni-SiC протонным облучением.** В.В. Козловский, П.А. Иванов, Д.С. Румянцев, В.Н. Ломасов, Т.П. Самсонова 7 778
- Излучательная рекомбинация в пленках SiO₂, имплантированных ионами Ge⁺ и отожженных в условиях гидростатического сжатия.** И.Е. Тыщенко, Л. Реболе 7 852
- Технология получения и возможности управления характеристиками структур с квантовыми точками.** В.М. Устинов 8 963
- О возможностях подавления формирования dome-кластеров при молекулярно-пучковой эпитаксии Ge на Si(100).** А.А. Тонких, Г.Э. Цырлин, В.Г. Дубровский, В.М. Устинов, P. Werner 10 1239
- Свойства нановискеров GaAs на поверхности GaAs(111)В, полученных комбинированным методом.** А.А. Тонких, Г.Э. Цырлин, Ю.Б. Самсоенко, И.П. Сошников, В.М. Устинов 10 1256
- Твердые растворы (C₂^{IV})_{1-x}(A^{III}B^V)_x, полученные из ограниченного объема оловянного раствора-расплава.** Б. Сапасев, М.С. Саидов, А.С. Саидов, С.Ж. Каражанов 11 1285
- Исследование разрыва зон на гетеропереходе напряженных короткопериодных сверхрешеток GaAs/GaAsP методом спектроскопии фотоотражения.** Л.П. Авакянц, П.Ю. Боков, Т.П. Колмакова, А.В. Червяков 12 1429
- Ловушки с энергиями вблизи середины запрещенной зоны на границе Si/SiO₂, созданной сращиванием, в структурах кремний-на-изоляторе.** И.В. Антонова, В.П. Попов, В.И. Поляков, А.И. Руковишников . . . 12 1439
- Кинетика роста поверхностного аморфного слоя при низкотемпературном облучении кремния быстрыми тяжелыми ионами.** А.Ю. Азаров 12 1445

5. Электронная структура, электрические, магнитные и оптические свойства (PACS 70)

5.1. Электронные состояния (PACS 71)

- Влияние водорода на электронную структуру и свойства нитрида бора.** С.Е. Кулькова, Д.В. Чудинов, Д.В. Ханин 1 61
- Наблюдение бозе-конденсации куперовских пар в полупроводниковых твердых растворах (Pb_{1-x}Sn_x)_{1-z}In_zTe.** С.А. Немов, П.П. Серегин, В.П. Волков, Н.П. Серегин, Д.В. Шамшур 2 190
- О природе гистерезиса низкотемпературного прыжкового магнетосопротивления вблизи перехода металл-изолятор в компенсированном Ge:Ga.** С.В. Егоров, А.Г. Забродский, Р.В. Парфеньев 2 197
- Спектроскопия экситонных поляритонов в напряженных полупроводниковых структурах A^{II}B^{VI} с широкими квантовыми ямами.** С.А. Марков, Р.П. Сейсян, В.А. Кособукин 2 230
- Роль сплавных эффектов в формировании электронной структуры неупорядоченных твердых растворов III-нитридов.** А.В. Возный, В.Г. Дейбук 3 316
- Электрон-фононный фактор затухания квантования Ландау 2D электронов с тонкой структурой энергетического спектра.** В.И. Кадушкин 4 412
- Экситонная фотолуминесценция в легированных квази-1D структурах на основе кремния.** А.В. Саченко, Д.В. Корбутяк, Ю.В. Крюченко, О.М. Сресели . 4 479
- Коэффициенты захвата свободных экситонов мелкими акцепторами и донорами в арсениде галлия.** К.Д. Глинчук, Н.М. Литовченко, О.Н. Стрельчук . . 5 563
- Магнитные свойства углеродных структур.** Т.Л. Макарова 6 641
- Длинноволновый край спектра излучения горячей электронно-дырочной плазмы в фотовозбужденном арсениде индия.** Э. Шатковскис, А. Чеснис 6 670

Светочувствительные полиимиды, содержащие в цепи замещенные дифенилметановые фрагменты. Е.Л. Александрова, Г.И. Носова, Н.А. Соловская, К.А. Ромашкова, В.А. Лукьяшина, Е.В. Конозобко, В.В. Кудрявцев	6	678
Спектроскопия экситонных состояний квантовых молекул InAs. В.Г. Талалаев, J.W. Tomp, N.D. Zakharov, P. Werner, Б.В. Новиков, Г.Э. Цырлин, Ю.Б. Самсоненко, А.А. Тонких, В.А. Егоров, Н.К. Поляков, В.М. Устинов	6	723
Особенности электронного парамагнитного резонанса в 4H-SiC в области фазового перехода изолятор–металл. II. Анализ ширины и формы линий. А.И. Вейнгер, А.Г. Забродский, Т.В. Тиснек, Е.Н. Мохов	7	816
Локализация продольного автосолитона в антимониде индия. И.К. Камиллов, А.А. Степуренко, А.С. Ковалев	7	822
Проявление квантово-размерных осцилляций времени излучательной экситонной рекомбинации в фотолуминесценции кремниевых наноструктур. А.В. Саченко, Ю.В. Крюченко, И.О. Соколовский, О.М. Срессели	7	877
Распределение плотности электронных состояний в запрещенной зоне микрокристаллического гидрированного кремния. А.Г. Казанский, К.Ю. Хабарова	10	1261
Светочувствительные свойства тонких полупроводниковых пленок наноккомпозитов на основе металлорганических комплексов Cu^+ и Ru^{2+} . Е.Л. Александрова, Н.Н. Химич	11	1321
Колесательные моды и электронно-фононное взаимодействие в полупроводниковых нанотрубках. А.И. Ведерников, А.В. Чаплик	11	1358

5.1.1. Уровни дефектов и примесей (PACS 71.55)

Компенсация доноров в обедненном слое кристаллов CdF_2 с барьером Шоттки. А.С. Щеулин, А.К. Купчиков, А.Е. Ангервакс, А.И. Рыскин	1	72
Примесные состояния олова в твердых растворах $Bi_2Te_{3-x}Se_x$ ($x = 0.06, 0.12$). М.К. Житинская, С.А. Немов, Т.Е. Свечникова, Е. Мюллер	2	186
3d-примеси замещения в кубическом карбиде кремния. И.И. Парфенова	2	194
Диффузия хрома в арсениде галлия. С.С. Хлудков, О.Б. Корецкая, А.В. Тяжев	3	274
Критический анализ исследования глубоких уровней в высокоомных монокристаллах CdS методом фотоэлектрической нестационарной спектроскопии. А.П. Одринский	3	310
Diffusion of Chromium in Thin Hydrogenated Amorphous Silicon Films. S.K. Persheyev, P.R. Drapacz, M.J. Rose, A.G. Fitzgerald	3	358
Емкостные исследования электронных ловушек в низкотемпературном арсениде галлия. П.Н. Брунков, А.А. Гуткин, А.К. Моисеенко, Ю.Г. Мусихин, В.В. Чалдышев, Н.Н. Черкашин, С.Г. Конников, В.В. Преображенский, М.А. Путьято, Б.Р. Семягин	4	401

A Small-Molecule Organic Semiconductor. F. Yakuphanoglu, M. Aydin, N. Arsu, M. Sekerci	4	486
Равновесные характеристики и низкотемпературная фотолуминесценция монокристаллов CdTe:Pb. А.В. Савицкий, О.А. Парфенюк, М.И. Илащук, А.И. Савчук, С.Н. Чупыра	5	516
Исследование рекомбинационных центров в облученных кристаллах p-Si. Т.А. Пагава	6	665
Формирование электрически активных центров в кремнии, облученном электронами, в интервале температур 400–700°С. Е.П. Неустроев, С.А. Смагулова, И.В. Антонова, Л.Н. Сафронов	7	791
Особенности отжига радиационных дефектов в кремниевых p–n-структурах: роль примесных атомов железа. Б.А. Комаров	9	1079
Исследование глубоких уровней в CdHgTe методом туннельного тока фотодиодов. В.И. Туринов	9	1129
Электронные и структурные переходы в сплавах $Pb_{1-x}Ge_xTe:Ga$ под давлением. Е.П. Скипетров, Е.А. Зверева, О.С. Волкова, А.В. Голубев, А.Ю. Моллаев, Р.К. Арсланов, В.Е. Слынько	10	1199
Распределение плотности электронных состояний в запрещенной зоне микрокристаллического гидрированного кремния. А.Г. Казанский, К.Ю. Хабарова	10	1261
Примесные центры редкоземельных ионов (Eu, Sm, Er) в вюрцитных кристаллах GaN. В.В. Криволапчук, Ю.В. Кожанова, В.В. Лундин, М.М. Мездрогина, С.Н. Родин, Ш.А. Юсупова	11	1308

5.2. Транспортные явления (PACS 72)

Стабилизация уровня Ферми и отрицательное магнитосопротивление в $PbTe(Mn,Cr)$. А.В. Морозов, А.Е. Кожанов, А.И. Артамкин, Е.И. Слынько, В.Е. Слынько, W.D. Dobrowolski, T. Story, Д.Р. Хохлов	1	30
Электрические свойства монокристаллов $MnIn_2S_4$. Н.Н. Нифтиев	2	166
Рассеяние квазидвумерных электронов сверхрешетки $GaAs/Al_xGa_{1-x}As$ на фононах. С.И. Борисенко	2	207
Транспортные явления в крупнозернистых поликристаллах CdTe. С.А. Колосов, Ю.В. Клевков, А.Ф. Плотников	3	305
Электрические свойства мелкозернистых поликристаллов CdTe. С.А. Колосов, Ю.В. Клевков, А.Ф. Плотников	4	473
A Small-Molecule Organic Semiconductor. F. Yakuphanoglu, M. Aydin, N. Arsu, M. Sekerci	4	486
Взаимосвязь спиновых структурных дефектов и проводимости в пленках гидрированного нанокристаллического кремния с добавками углерода. О.И. Шевалеевский, А.А. Цветков, Л.Л. Ларина, S.Y. Myong, K.S. Lim	5	547
Тензорезистивный эффект в слоях пористого кремния с различной морфологией. С.П. Зимин, А.Н. Брагин	5	616
Магнитные свойства углеродных структур. Т.Л. Макарова	6	641
Исследование рекомбинационных центров в облученных кристаллах p-Si. Т.А. Пагава	6	665

- Формирование толстых слоев пористого кремния при недостаточной концентрации неосновных носителей. Д.Н. Горячев, Л.В. Беляков, О.М. Сресели 6 739
- Исследование электрофизических свойств $\text{Cd}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}$. П.В. Бирюлин, В.И. Кошелева, В.И. Туринов 7 784
- Электрофизические свойства и предельное положение уровня Ферми в InSb , облученном протонами. В.Н. Брудный, В.М. Бойко, И.В. Каменская, Н.Г. Колин 7 802
- Особенности электронного парамагнитного резонанса в 4H-SiC в области фазового перехода изолятор–металл. II. Анализ ширины и формы линий. А.И. Вейнгер, А.Г. Забродский, Т.В. Тиснек, Е.Н. Мохов 7 816
- Влияние размерного квантования спектра акустических фононов на рассеяние электронов в сверхрешетке $\text{GaAs}/\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$. С.И. Борисенко 7 858
- Ударно-ионизационные автосолиитоны в компенсированном кремнии. А.М. Мусаев 9 1030
- Низкочастотный шум в эпитаксиальных слоях нитрида галлия с разной степенью упорядоченности мозаичной структуры. Н.М. Шмидт, М.Е. Левинштейн, В.В. Лундин, А.И. Бесюлькин, П.С. Копьев, S.L. Rumyantsev, N. Pala, M.S. Shur 9 1036
- Оптические и электрические свойства 4H-SiC , облученного нейтронами и тяжелыми ионами высоких энергий. Е.В. Калинина, Г.Ф. Холуянов, Г.А. Онушкин, Д.В. Давыдов, А.М. Стрельчук, А.О. Константинов, А. Halléп, А.Ю. Никифоров, В.А. Скуратов, К. Navacsak 10 1223
- Сверхвысокочастотные полевые транзисторы на основе нитридов III группы. С.Б. Александров, Д.А. Баранов, А.П. Кайдаш, Д.М. Красовицкий, М.В. Павленко, С.И. Петров, Ю.В. Погорельский, И.А. Соколов, М.В. Степанов, В.П. Чалый, Н.Б. Гладышева, А.А. Дорофеев, Ю.А. Матвеев, А.А. Чернявский 10 1275
- Фотоэлектрические свойства структур $\text{ZnO}/\text{CuPc}/\text{Si}$. Г.А. Ильчук, С.Е. Никитин, Ю.А. Николаев, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Теруков 11 1349
- Электропроводность и термоэдс жидкого теллура с примесями переходных 3d-металлов. В.М. Склярчук, Ю.О. Плевачук 12 1409
- $\text{Hg}_{1-x-y-z}\text{Cd}_x\text{Mn}_y\text{Zn}_z\text{Te}$: новая альтернатива $\text{Hg}_{1-x}\text{Cd}_x\text{Te}$. И.Н. Горбатюк, А.В. Марков, С.Э. Остапов, И.М. Раренко 12 1414
- 5.2.1. Явления электронной проводимости в полупроводниках (PACS 72.20)**
- Стабилизация уровня Ферми и отрицательное магнетосопротивление в $\text{PbTe}(\text{Mn},\text{Cr})$. А.В. Морозов, А.Е. Кожанов, А.И. Артамкин, Е.И. Слынько, В.Е. Слынько, W.D. Dobrowolski, T. Story, Д.Р. Хохлов 1 30
- Структурно сложные двухдырочные и двухэлектронные медленные ловушки с бикинетическими свойствами в кристаллах $p\text{-ZnTe}$, $n\text{-ZnS}$. М.А. Ризаханов, Е.М. Зобов, М.М. Хамидов 1 49
- Универсальный метод аналитической аппроксимации подвижности основных носителей заряда в полупроводниках в широком диапазоне температур и уровней легирования. Т.Т. Мнацаканов, М.Е. Левинштейн, Л.И. Поморцева, С.Н. Юрков 1 56
- Влияние водорода на электронную структуру и свойства нитрида бора. С.Е. Кулькова, Д.В. Чудинов, Д.В. Ханин 1 61
- Электрические свойства монокристаллов MnIn_2S_4 . Н.Н. Нифтиев 2 166
- Нелинейность пьезорезистивного эффекта в пленках поликристаллического кремния. В.А. Гридчин, В.М. Любимский 2 179
- Примесные состояния олова в твердых растворах $\text{Bi}_2\text{Te}_{3-x}\text{Se}_x$ ($x = 0.06, 0.12$). М.К. Житинская, С.А. Немов, Т.Е. Свечникова, Е. Мюллер 2 186
- Рассеяние квазидвумерных электронов сверхрешетки $\text{GaAs}/\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ на фононах. С.И. Борисенко 2 207
- Определение концентрации галлия в германии, трансмутационно легированном нейтронами, из измерений сопротивления в области прыжковой проводимости. О.П. Ермолаев, Т.Ю. Миккульчик 3 285
- Роль объемного заряда в формировании сопротивления биполярного полупроводникового образца. А. Конин 3 296
- Электрические свойства слоистых монокристаллов FeGaInS_4 . Н.Н. Нифтиев 5 522
- Подвижность неосновных носителей заряда в пленках $p\text{-HgCdTe}$. В.С. Варавин, С.А. Дворецкий, В.Я. Костюченко, В.Н. Овсяк, Д.Ю. Протасов 5 532
- Электрические свойства MnIn_2Se_4 . Н.Н. Нифтиев, М.А. Алиджанов, О.Б. Тагиев, Ф.М. Мамедов, М.Б. Мурадов 5 550
- Исследование рекомбинационных центров в облученных кристаллах $p\text{-Si}$. Т.А. Пагава 6 665
- Исследование электрофизических свойств $\text{Cd}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}$. П.В. Бирюлин, В.И. Кошелева, В.И. Туринов 7 784
- Особенности термоэлектрических свойств слабо легированных твердых растворов $\text{Bi}_2(\text{TeSe})_3$. П.П. Константинов, Л.В. Прокофьева, Ю.И. Равич, М.И. Федоров, В.В. Компаниец 7 811
- Intermediate band solar cells: comparison with Shockley–Read–Hall recombination. A. Martí, L. Cuadra, N. López, A. Luque 8 985
- Пьезосопротивление в пленках поликристаллического кремния p -типа. В.А. Гридчин, В.М. Любимский 8 1013
- Ударно-ионизационные автосолиитоны в компенсированном кремнии. А.М. Мусаев 9 1030
- Дрейфовая подвижность носителей заряда в пористом карбиде кремния. Л.П. Казакова, М.Г. Мынбаева, К.Д. Мынбаев 9 1118
- Электронные и структурные переходы в сплавах $\text{Pb}_{1-x}\text{Ge}_x\text{Te}:\text{Ga}$ под давлением. Е.П. Скипетров, Е.А. Зверева, О.С. Волкова, А.В. Голубев, А.Ю. Моллаев, Р.К. Арсланов, В.Е. Слынько 10 1199

- Расчет термоэлектрической эффективности многослойных структур с квантовыми ямами в случае полярного рассеяния носителей на оптических фононах. Д.А. Пшенай-Северин, Ю.И. Равич 10 1251
- Электронный магнетотранспорт в связанных квантовых ямах с двухсторонним легированием. Г.Б. Галиев, В.Э. Каминский, И.С. Васильевский, В.А. Кульбачинский, Р.А. Лунин 11 1368
- 5.2.2. Высокочастотные эффекты и эффекты обусловленные плазмой (PACS 72.30)**
- Особенности электрического транспорта в анизотропно наноструктурированном кремнии. П.А. Форш, Л.А. Осминкина, В.Ю. Тимошенко, П.К. Кашкаров 5 626
- Локализация продольного автосолитона в антимониде индия. И.К. Камилов, А.А. Степуренко, А.С. Ковалев 7 822
- Определение времени жизни неосновных носителей заряда в слитках кремния по релаксации фотопроводимости, измеренной на сверхвысоких частотах. П.А. Бородовский, А.Ф. Булдыгин, А.С. Токарев 9 1043
- 5.2.3. Фотопроводимость и фотовольтаический эффект (PACS 72.40)**
- Транспортные явления в крупнозернистых поликристаллах CdTe. С.А. Колосов, Ю.В. Клевков, А.Ф. Плотников 3 305
- Фотоэлементы на основе гетероструктур GaAs/Ge, полученные комбинацией методов МОСГФЭ и диффузии цинка. В.М. Андреев, В.П. Хвостиков, Н.А. Калюжный, С.С. Титков, О.А. Хвостикова, М.З. Шварц 3 369
- СВЧ фотопроводимость и фотодиэлектрический эффект в тонких пленках PbS, полученных из тиомочевинных координационных соединений. Н.Л. Сермакашева, Г.Ф. Новиков, Ю.М. Шульга, В.Н. Семенов 4 395
- Электрические свойства мелкозернистых поликристаллов CdTe. С.А. Колосов, Ю.В. Клевков, А.Ф. Плотников 4 473
- Подвижность неосновных носителей заряда в пленках p-HgCdTe. В.С. Варавин, С.А. Дворецкий, В.Я. Костюченко, В.Н. Овсяк, Д.Ю. Протасов . . . 5 532
- Фотопроводимость полимерных композиций с высокой концентрацией органических красителей. Н.А. Давиденко, А.А. Ищенко, Л.И. Костенко, Н.Г. Кувшинский, Д.Д. Мысык, Р.Д. Мысык 5 610
- Анализ поляризационно-модуляционных спектров индуцированного одноосным сжатием фотоплекроизма в кристалле Ge. И.Е. Матяш, Б.К. Сердега 6 684
- Исследование электрофизических свойств $Cd_xHg_{1-x}Te$. П.В. Бирюлин, В.И. Кошелева, В.И. Турин 7 784
- Роль уровней прилипания неравновесных электронов в процессе образования центров закрепления доменных стенок в магнитном полупроводнике $CdCr_2Se_4$. А.А. Абдуллаев 7 796
- Термофотоэлектрические преобразователи теплового и концентрированного солнечного излучения. В.П. Хвостиков, О.А. Хвостикова, П.Ю. Газарян, М.З. Шварц, В.Д. Румянцев, В.М. Андреев 8 988
- Определение времени жизни неосновных носителей заряда в слитках кремния по релаксации фотопроводимости, измеренной на сверхвысоких частотах. П.А. Бородовский, А.Ф. Булдыгин, А.С. Токарев 9 1043
- Фоточувствительные структуры на основе монокристаллического кремния и пленок фталоцианина CuPc. Получение и свойства. Г.А. Ильчук, Н.В. Климова, О.И. Коньков, С.Е. Никитин, Ю.А. Николаев, Л.И. Рудая, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Теруков, В.В. Шаманин, Т.А. Юрре 9 1056
- Влияние супрамолекулярного упорядочения на фотофизические свойства полиамидинов. Е.Л. Александрова, М.Е. Компан, М.М. Дудкина, А.В. Теньковцев, Е.И. Теруков 9 1110
- Создание и фоточувствительность гетеропереходов на кристаллах $CuIn_3Se_5$. И.В. Боднар, С.Е. Никитин, Г.А. Ильчук, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, М.В. Якушев . 10 1228
- Влияние сероводорода на электрические и фотоэлектрические свойства гетероструктур $Al-p-Si-SnO_2:Cu-Ag$. С.В. Слободчиков, Е.В. Руссу, Э.В. Иванов, Ю.Г. Малинин, Х.М. Салихов 10 1234
- Фоточувствительные структуры на монокристаллах $HgGa_2S_4$: создание и свойства. В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Б.Х. Байрамов, Г.А. Ильчук, В.О. Украинец, Н. Фернелиус, П.Г. Шунеманн 11 1332
- Фотоэлектрические свойства структур $ZnO/CuPc/Si$. Г.А. Ильчук, С.Е. Никитин, Ю.А. Николаев, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Теруков 11 1349
- Влияние сероводорода на фотоэлектрические характеристики изотипных гетероструктур $Al-p-Si-SnO_2:Cu-Ag$. С.В. Слободчиков, Е.В. Руссу, Э.В. Иванов, Ю.Г. Малинин, Х.М. Салихов 12 1426
- 5.2.4. Шумы (PACS 72.70)**
- Особенности электрического транспорта в анизотропно наноструктурированном кремнии. П.А. Форш, Л.А. Осминкина, В.Ю. Тимошенко, П.К. Кашкаров 5 626
- 5.3. Электронная структура и электрические свойства поверхностей, границ раздела и тонких пленок (PACS 73)**
- Теория пороговых характеристик полупроводниковых лазеров на квантовых точках. Л.В. Асрян, Р.А. Сурис 1 3
- О природе гистерезиса низкотемпературного прыжкового магнетосопротивления вблизи перехода металл-изолятор в компенсированном Ge:Ga. С.В. Егоров, А.Г. Забродский, Р.В. Парфеньев 2 197

- Влияние содержания In и Al на характеристики собственных дефектов в квантовых точках на основе арсенида галлия.** Т.В. Безъязычная, В.М. Зеленковский, Г.И. Рябцев, М.М. Соболев . . . 2 213
- Фоточувствительность структур с квантовыми ямами, выращенных методом МОС-гидридной эпитаксии, при нормальном падении излучения.** В.Б. Куликов, Г.Х. Аветисян, Л.М. Василевская, И.Д. Залевский, И.В. Будкин, А.А. Падалица 2 218
- Энергетическая структура A^{+} -центров в квантовых ямах.** Н.С. Аверкиев, А.Е. Жуков, Ю.Л. Иванов, П.В. Петров, К.С. Романов, А.А. Тонких, В.М. Устинов, Г.Э. Цырлин 2 222
- Спектроскопия экситонных поляритонов в напряженных полупроводниковых структурах $A^{IV}B^{VI}$ с широкими квантовыми ямами.** С.А. Марков, Р.П. Сейсян, В.А. Кособукин 2 230
- Сверхскоростной электронный дрейф в полевых полупроводниковых структурах с секционированным каналом.** В.А. Гергель, Ю.В. Гуляев, А.П. Зеленый, М.Н. Якупов 2 237
- Уширение спектральных линий в квантовых ямах при кулоновском взаимодействии носителей заряда.** А.А. Афоненко 3 335
- Управление энергетическим спектром квантовых точек InAs/GaAs изменением толщины и состава тонкого двойного покровного слоя GaAs/InGaAs.** И.А. Карпович, Б.Н. Звонков, С.Б. Левичев, Н.В. Байдусь, С.В. Тихов, Д.О. Филатов, А.П. Горшков, С.Ю. Ермаков 4 448
- Исследования физических явлений в полупроводниковых наноструктурах с использованием планарно-неоднородных слоев. Фотолюминесценция туннельно-связанных квантовых ям.** Ю.В. Хабаров, В.В. Капаев, В.А. Петров 4 455
- Определение профиля распределения концентрации носителей заряда в слабосвязанных сверхрешетках GaAs/AlGaAs.** П.Н. Брунков, С.О. Усов, Ю.Г. Мусихин, А.Е. Жуков, Г.Э. Цырлин, В.М. Устинов, С.Г. Конников, Г.К. Расулова 4 469
- Геометрическая структура и спектральные характеристики электронных состояний кремниевых наночастиц.** С.И. Курганский, Н.А. Борщ 5 580
- Люминесценция ступенчатых квантовых ям в структурах GaAs/GaAlAs и InGaAs/GaAs/GaAlAs.** В.Ф. Агекян, Ю.А. Степанов, И. Акаи, Т. Карасава, Л.Е. Воробьев, Д.А. Фирсов, А.Е. Жуков, В.М. Устинов, А. Зейлмейер, С. Шмидт, С. Ханна, Е. Зирик 5 585
- Вертикальный транспорт горячих электронов в сверхрешетках GaAs/AlAs.** Д.Н. Мирлин, В.Ф. Сапега, В.М. Устинов 5 598
- Магнитные свойства углеродных структур.** Т.Л. Макарова 6 641
- Долговременные релаксации проводимости квазидвумерных сильно разупорядоченных МДП структур.** А.Б. Давыдов, Б.А. Аронзон 6 693
- Спектроскопия экситонных состояний квантовых молекул InAs.** В.Г. Талалаев, J.W. Tomm, N.D. Zakharov, P. Werner, Б.В. Новиков, Г.Э. Цырлин, Ю.Б. Самсоненко, А.А. Тонких, В.А. Егоров, Н.К. Поляков, В.М. Устинов 6 723
- Влияние размерного квантования спектра акустических фононов на рассеяние электронов в сверхрешетке GaAs/Al_xGa_{1-x}As.** С.И. Борисенко 7 858
- Эффект Капицы в кристаллах со сверхрешеткой.** П.В. Горский 7 864
- Оптические и структурные свойства массивов квантовых точек InAs, осажденных в матрицу In_xGa_{1-x}As на подложке GaAs.** Н.В. Крыжановская, А.Г. Гладышев, С.А. Блохин, Ю.Г. Мусихин, А.Е. Жуков, М.В. Максимов, Н.Д. Захаров, А.Ф. Цацульников, Н.Н. Леденцов, P. Werner, F. Guffart, D. Bimberg 7 867
- Механизм сверхизлучения Дике в полупроводниковых гетероструктурах.** Л.Я. Карачинский, И.И. Новиков, Н.Ю. Гордеев, Г.Г. Зегря 7 872
- Quantum dot solar concentrators.** A.J. Chatten, K.W.J. Barnham, V.F. Buxton, N.J. Ekins-Daukes, M.A. Malik 8 949
- Электрические свойства наноконтактов металл-полупроводник.** Н.В. Востоков, В.И. Пашкин 9 1084
- Влияние электронно-электронных и электронно-дырочных столкновений на внутризонную инверсную населенность электронов в ступенчатых квантовых ямах.** В.Л. Зерова, Г.Г. Зегря, Л.Е. Воробьев 9 1090
- Расчет вольт-амперных характеристик симметричных двухбарьерных резонансно-туннельных структур на основе арсенида галлия с учетом процессов разрушения когерентности электронных волн в квантовой яме.** Д.В. Поздняков, В.М. Борздов, Ф.Ф. Комаров 9 1097
- Релаксация носителей заряда в квантовых точках с участием плазмон-фононных мод.** А.В. Федоров, А.В. Баранов 9 1101
- Токовая неустойчивость с S-образной вольт-амперной характеристикой в слоях металл-полимерного комплекса полиаминокислоты с Tb⁺².** Э.А. Лебедев, М.Я. Гойхман, К.Д. Цэндин, И.В. Подешво, Е.И. Теруков, В.В. Кудрявцев 9 1115
- Характеристики планарных диодов терагерцового диапазона частот на основе сильно легированных GaAs/AlAs-сверхрешеток.** Д.Г. Павельев, Н.В. Демарина, Ю.И. Кошуринов, А.П. Васильев, Е.С. Семенова, А.Е. Жуков, В.М. Устинов 9 1141
- Светочувствительные полимерные полупроводники.** Е.Л. Александрова 10 1153
- Влияние центров безызлучательной рекомбинации на эффективность фотолюминесценции структур с квантовыми точками.** М.В. Максимов, Д.С. Сизов, А.Г. Макаров, И.Н. Каяндер, Л.В. Асрян, А.Е. Жуков, В.М. Устинов, Н.А. Черкашин, Н.А. Берг, Н.Н. Леденцов, D. Bimberg 10 1245

Расчет термоэлектрической эффективности многослойных структур с квантовыми ямами в случае полярного рассеяния носителей на оптических фононах. Д.А. Пшеннай-Северин, Ю.И. Равич	10	1251
Кинетика трансформации домена электрического поля в слабо связанных сверхрешетках в поперечном электрическом поле. Ю.А. Митягин, В.Н. Мурзин, Ю.А. Ефимов, А.А. Пищулин, В.Н. Пырков	11	1353
Колебательные моды и электронно-фононное взаимодействие в полупроводниковых нанотрубках. А.И. Ведерников, А.В. Чаплик	11	1358
Междозонное поглощение света в селективно легированных асимметричных двойных туннельно-связанных квантовых ямах. В.Л. Зерова, В.В. Капаев, Л.Е. Воробьев, Д.А. Фирсов, S. Schmidt, Е.А. Зибик, А. Seilmeier, E. Towe	12	1455

5.3.1. Электронные состояния на поверхностях и границах раздела (PACS 73.20)

Резонансные переходы электрона между полупроводниковыми квантовыми точками под действием лазерного излучения. А.В. Цуканов, Л.А. Опенов	1	94
О статистике и кинетике рекомбинации в полупроводниковых наноструктурах. А.В. Саченко, Ю.В. Крюченко	1	102
Влияние примеси золота на фотолюминесценцию и фотоэдс пористого кремния. Е.Ф. Венгер, С.И. Кириллова, И.М. Кизяк, Э.Г. Манойлов, В.Е. Примаченко	1	117
Рассеяние квазидвумерных электронов сверхрешетки GaAs/Al _x Ga _{1-x} As на фононах. С.И. Борисенко	2	207
Естественно неупорядоченный потенциал на поверхности сильно легированного полупроводника. В.Б. Бондаренко, В.В. Кораблев, Ю.И. Равич	3	331
Размерный эффект Штарка и электропоглощение в полупроводниковом сферическом слое. В.А. Арутюнян, К.С. Арамян, Г.Ш. Петросян	3	349
Энергетические состояния в короткопериодных симметричных и асимметричных сверхрешетках (GaAs) _N /(AlAs) _M . Зависимость от граничных условий. К.Е. Глухов, А.И. Берча, Д.В. Корбутяк, В.Г. Литовченко	4	426
Резонансное Г-Х-туннелирование в однобарьерных гетероструктурах GaAs/AlAs/GaAs. Ю.Н. Ханин, Е.Е. Вдовин, Ю.В. Дубровский	4	436
Экситонная фотолюминесценция в легированных квази-1D структурах на основе кремния. А.В. Саченко, Д.В. Корбутяк, Ю.В. Крюченко, О.М. Сресели	4	479
Структурные дефекты на границе раздела сегнетоэлектрик-полупроводник. Л.С. Берман, И.Е. Титков	6	710
Электрон-электронное рассеяние в ступенчатых квантовых ямах. В.Л. Зерова, Л.Е. Воробьев, Г.Г. Зегря	6	716
Эффект Капицы в кристаллах со сверхрешеткой. П.В. Горский	7	864

Механизм сверхизлучения Дике в полупроводниковых гетероструктурах. Л.Я. Карачинский, И.И. Новиков, Н.Ю. Гордеев, Г.Г. Зегря	7	872
Релаксация носителей заряда в квантовых точках с участием плазмон-фононных мод. А.В. Федоров, А.В. Баранов	9	1101
Электронный магнетотранспорт в связанных квантовых ямах с двухсторонним легированием. Г.Б. Галиев, В.Э. Каминский, И.С. Васильевский, В.А. Кульбачинский, Р.А. Лунин	11	1368
Резонансные переходы электрона между тремя полупроводниковыми квантовыми точками под действием лазерного излучения. А.В. Цуканов	11	1382
Ловушки с энергиями вблизи середины запрещенной зоны на границе Si/SiO ₂ , созданной сращиванием, в структурах кремний-на-изоляторе. И.В. Антонова, В.П. Попов, В.И. Поляков, А.И. Руковишников	12	1439

5.3.2. Барьеры Шоттки (PACS 73.30)

Компенсация доноров в обедненном слое кристаллов CdF ₂ с барьером Шоттки. А.С. Щеулин, А.К. Купчиков, А.Е. Ангервакс, А.И. Рыскин	1	72
Фоточувствительные структуры на основе соединения AgIn ₁₁ S ₁₇ . И.В. Боднарь, Г.А. Ильчук, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь	2	168
Структуры на основе полупроводниковых соединений Cu(Ag)In _n S _m . И.В. Боднарь, В.А. Полубок, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, М.С. Сергинов	2	202
Естественно неупорядоченный потенциал на поверхности сильно легированного полупроводника. В.Б. Бондаренко, В.В. Кораблев, Ю.И. Равич	3	331
Фоточувствительность структур на пятикомпонентных твердых растворах изоэлектронного ряда германия. А.А. Вайполин, Ю.А. Николаев, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Теруков	4	422
Определение профиля распределения концентрации носителей заряда в слабосвязанных сверхрешетках GaAs/AlGaAs. П.Н. Брунков, С.О. Усов, Ю.Г. Мухомин, А.Е. Жуков, Г.Э. Цырлин, В.М. Устинов, С.Г. Конников, Г.К. Расулова	4	469
Характеристики детекторов ядерного излучения на основе полупроводящего арсенида галлия. Е.М. Вербицкая, В.К. Еремин, А.М. Иванов, Н.Б. Строкан, В.И. Васильев, В.Н. Гаврин, Е.П. Веретенкин, Ю.П. Козлова, В.Б. Куликов, А.В. Марков, А.Я. Поляков	4	490
Исследование физических механизмов лазерной коррекции и стабилизации параметров структур Al-n-n ⁺ -Si-Al с барьером Шоттки. Г.И. Воробец, М.М. Воробец, В.Н. Стребжев, Е.В. Бузанева, А.Г. Шкавро	6	690
Формирование потенциальных барьеров на контакте металл-полупроводник с использованием метода селективного удаления атомов. Б.А. Гурович, Б.А. Аронзон, В.В. Рыльков, Е.Д. Ольшанский, Е.А. Кулешова, Д.И. Долгий, Д.Ю. Ковалев, В.И. Филиппов	9	1074

- Электрические свойства наноконтактов металл–полупроводник. Н.В. Востоков, В.И. Шашкин 9 1084
- Создание и фоточувствительность гетеропереходов на кристаллах CuIn_3Se_5 . И.В. Боднар, С.Е. Никитин, Г.А. Ильчук, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, М.В. Якушев . 10 1228
- 5.3.3. Транспортные явления в структурах, содержащих границы раздела (PACS 73.40)**
- Формирование омических контактов к полупроводящему GaAs путем лазерного осаждения In. В. Казлаускас, В. Кажукаускас, Ю. Мишкинис, А. Петравичюс, Р. Пурас, С. Сакалаускас, Ю. Синюс, Ю.-В. Вайткус, А. Жиндулис 1 79
- Фоточувствительные структуры на основе соединения $\text{AgIn}_{11}\text{S}_{17}$. И.В. Боднар, Г.А. Ильчук, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь 2 168
- Структуры на основе полупроводниковых соединений $\text{Cu}(\text{Ag})\text{In}_n\text{S}_m$. И.В. Боднар, В.А. Полубок, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, М.С. Сергинов 2 202
- Экспериментальное исследование $p-i-n$ -диодов на основе SiC в 3-сантиметровом диапазоне. К.В. Василевский, П.Б. Гамулецкая, А.В. Кириллов, А.А. Лебедев, Л.П. Романов, В.А. Смирнов 2 242
- Фотоэлементы на основе гетероструктур GaAs/Ge, полученные комбинацией методов МОСГФЭ и диффузии цинка. В.М. Андреев, В.П. Хвостиков, Н.А. Калюжный, С.С. Титков, О.А. Хвостикова, М.З. Шварц 3 369
- Электрон-фононный фактор затухания квантования Ландау 2D электронов с тонкой структурой энергетического спектра. В.И. Кадушкин 4 412
- Получение гетероструктур окисел– p -InSe с улучшенными фотоэлектрическими характеристиками. В.Н. Катеринчук, З.Д. Ковалюк 4 417
- Резонансное Γ - X -туннелирование в однобарьерных гетероструктурах GaAs/AlAs/GaAs. Ю.Н. Ханин, Е.Е. Вдовин, Ю.В. Дубровский 4 436
- Изменение контактной разности потенциалов фотодиода на основе гетероперехода n -InSe– p -GaSe в процессе „старения“. С.И. Драпак, В.Б. Орлецкий, З.Д. Ковалюк 5 566
- О предельной квантовой эффективности краевой электролюминесценции в кремниевых барьерных структурах. А.В. Саченко, А.П. Горбань, В.П. Костылев 5 570
- Теория туннельного токопереноса в контактах металл–полупроводник с приповерхностным изотипным δ -легированием. В.И. Шашкин, А.В. Мурель . 5 574
- Долговременные релаксации проводимости квазидвумерных сильно разупорядоченных МДП структур. А.Б. Давыдов, Б.А. Аронзон 6 693
- Особенности получения и некоторые свойства гетероперехода n -ZnO:Ga/ p -GaN:Mg/ α -Al₂O₃. Б.М. Атаев, Я.И. Алимов, В.В. Мамедов, С.Ш. Махмудов, Б.А. Магомедов 6 699
- Высококачественная барьерная емкость контакта металл–полупроводник и резкого p - n -перехода. В.И. Мурыгин 6 702
- Роль слоев $\text{Al}_{0.3}\text{Ga}_{0.7}\text{As}$, легированных Si, в высокочастотной проводимости гетероструктур GaAs/ $\text{Al}_{0.3}\text{Ga}_{0.7}\text{As}$ в режиме квантового эффекта Холла. И.Л. Дричко, А.М. Дьяконов, И.Ю. Смирнов, Ю.М. Гальперин, В.В. Преображенский, А.И. Торопов 6 729
- Мягкий пробой как причина спада тока в туннельной МОП структуре. А.Ф. Шулекин, С.Э. Тягинов, R. Khilil, A. El Hdiy, М.И. Векслер 6 753
- Стимулирование металлургических реакций на интерфейсе Ni–SiC протонным облучением. В.В. Козловский, П.А. Иванов, Д.С. Румянцев, В.Н. Ломасов, Т.П. Самсонова 7 778
- Фоточувствительные структуры на основе монокристаллического кремния и пленок фталоцианина CuPc. Получение и свойства. Г.А. Ильчук, Н.В. Климова, О.И. Коньков, С.Е. Никитин, Ю.А. Николаев, Л.И. Рудая, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Теруков, В.В. Шаманин, Т.А. Юрре 9 1056
- Излучательная рекомбинация в кремниевой туннельной МОП структуре. N. Asli, М.И. Векслер, И.В. Грехов, P. Seegebrecht, С.Э. Тягинов, А.Ф. Шулекин 9 1068
- Особенности отжига радиационных дефектов в кремниевых p - n -структурах: роль примесных атомов железа. Б.А. Комаров 9 1079
- Сверхвысокочастотные полевые транзисторы на основе нитридов III группы. С.Б. Александров, Д.А. Баранов, А.П. Кайдаш, Д.М. Красовицкий, М.В. Павленко, С.И. Петров, Ю.В. Погорельский, И.А. Соколов, М.В. Степанов, В.П. Чалый, Н.Б. Гладышева, А.А. Дорофеев, Ю.А. Матвеев, А.А. Чернявский 10 1275
- Влияние модификационного нанослоя висмута на перенос заряда в гетероструктурах Sb–Si(n)–Bi–Ge₃₃As₁₂Se₅₅–Sb . А.Б. Кондрат, Н.И. Попович, Н.И. Довгошей 11 1339
- Влияние термоэлектрического поля на вольт-амперную характеристику гетероперехода p -Ge– n -GaAs. М.М. Гаджиалиев, З.Ш. Пирмагомедов, Т.Н. Эфендиева 11 1343
- Гетероструктуры AlGaIn/GaN с высокой подвижностью электронов, выращенные методом газофазной эпитаксии из металлорганических соединений. В.В. Лундин, Е.Е. Заварин, А.И. Бесюлькин, А.Г. Гладышев, А.В. Сахаров, М.Ф. Кокорев, Н.М. Шмидт, А.Ф. Цацульников, Н.Н. Леденцов, Ж.И. Алфёров, Р. Каканаков 11 1364
- Электронный магнетотранспорт в связанных квантовых ямах с двухсторонним легированием. Г.Б. Галиев, В.Э. Каминский, И.С. Васильевский, В.А. Кульбачинский, Р.А. Лунин 11 1368
- Формирование двумерных и одномерных твердофазных квантовых наноструктур в системе CdHgTe–электролит. В.Б. Божевольнов, А.М. Яфясов, П.П. Коноров 11 1374

- Резонансные переходы электрона между тремя полупроводниковыми квантовыми точками под действием лазерного излучения. А.В. Цуканов . . . 11 1382
- Влияние сероводорода на фотоэлектрические характеристики изотипных гетероструктур Al—n-Si—SnO₂:Cu—Ag. С.В. Слободчиков, Е.В. Руссу, Э.В. Иванов, Ю.Г. Малинин, Х.М. Салихов 12 1426
- Влияние сверхкоротких импульсов электромагнитного излучения на параметры структур металл—диэлектрик—полупроводник. В.А. Терехов, А.Н. Манько, Е.Н. Бормонтов, В.Н. Левченко, С.Ю. Требунских, Е.А. Тутов, Э.П. Домашевская . . 12 1435

5.3.4. Транспортные явления в тонких пленках (PACS 73.50)

- Влияние примеси золота на фотолуминесценцию и фотоэдс пористого кремния. Е.Ф. Венгер, С.И. Кириллова, И.М. Кизяк, Э.Г. Манойлов, В.Е. Примаченко 1 117
- Нелинейность пьезорезистивного эффекта в пленках поликристаллического кремния. В.А. Гридчин, В.М. Любимский 2 179
- СВЧ фотопроводимость и фотодиэлектрический эффект в тонких пленках PbS, полученных из тиомочевинных координационных соединений. Н.Л. Сермакашева, Г.Ф. Новиков, Ю.М. Шульга, В.Н. Семенов 4 395
- Осцилляции наведенного фотоплетохроизма в гетеропереходах ZnO/GaAs. С.Е. Никитин, Ю.А. Николаев, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Теруков, N. Fernelius, J. Goldstein 4 407
- Получение гетероструктур окисел—p-InSe с улучшенными фотоэлектрическими характеристиками. В.Н. Катеринчук, З.Д. Ковалюк 4 417
- Электрические свойства мелкозернистых поликристаллов CdTe. С.А. Колосов, Ю.В. Клевков, А.Ф. Плотников 4 473
- Взаимосвязь спиновых структурных дефектов и проводимости в пленках гидрированного нанокристаллического кремния с добавками углерода. О.И. Шевалесевский, А.А. Цветков, Л.Л. Ларина, S.Y. Muong, K.S. Lim 5 547
- Выращивание и легирование магнием слоев InAs методом газофазной эпитаксии из металлоорганических соединений. Т.И. Воронина, Т.С. Лагунова, С.С. Кижаяев, С.С. Молчанов, Б.В. Пушный, Ю.П. Яковлев 5 556
- Роль слоев Al_{0.3}Ga_{0.7}As, легированных Si, в высокочастотной проводимости гетероструктур GaAs/Al_{0.3}Ga_{0.7}As в режиме квантового эффекта Холла. И.Л. Дричко, А.М. Дьяконов, И.Ю. Смирнов, Ю.М. Гальперин, В.В. Преображенский, А.И. Торопов 6 729
- Исследование собирания носителей в CdZnTe-детекторах рентгеновского и γ -излучения фотоэлектрическим методом. Л.А. Косяченко, Е.Л. Масляничук, И.М. Раренко, В.М. Склярчук 8 1018

- Низкочастотный шум в эпитаксиальных слоях нитрида галлия с разной степенью упорядоченности мозаичной структуры. Н.М. Шмидт, М.Е. Левинштейн, В.В. Лундин, А.И. Бесюлькин, П.С. Копьев, S.L. Rumyantsev, N. Pala, M.S. Shur 9 1036
- Характеристики планарных диодов терагерцового диапазона частот на основе сильно легированных GaAs/AlAs-сверхрешеток. Д.Г. Павельев, Н.В. Демарина, Ю.И. Кошуринов, А.П. Васильев, Е.С. Семенова, А.Е. Жуков, В.М. Устинов 9 1141
- Поведение варизонных детекторов ионизирующих излучений при облучении α -частицами. Л. Дапкус, К. Пожела, Ю. Пожела, А. Шиленас, В. Юцене, В. Ясутис 9 1147
- Распределение плотности электронных состояний в запрещенной зоне микрокристаллического гидрированного кремния. А.Г. Казанский, К.Ю. Хабарова 10 1261

5.4. Сверхпроводимость (PACS 74). Магнитные свойства (PACS 75), магнитные резонансы (PACS 76)

- Магнитные свойства теллурида кадмия, легированного германием. Ю.В. Шалдин, И. Вархульска, Ю.М. Иванов 2 172
- Магнитные исследования широкозонных полупроводников Cd_{1-x}Zn_xTe ($x = 0.12, 0.21$). Ю.В. Шалдин, И. Вархульска, М.Х. Рабаданов, В.К. Комарь 3 300
- Исследования методом электронного парамагнитного резонанса пленок нанокристаллического кремния, полученных импульсным лазерным осаждением. В.Я. Братусь, С.М. Окулов, Э.Б. Каганович, И.М. Кизяк, Э.Г. Манойлов 5 621
- Магнитные свойства углеродных структур. Т.Л. Макарова 6 641
- Локальная симметрия решетки Pb_{1-x}Sn_xSe в области бесчелового состояния. Э.С. Хужакулов 7 775
- Роль уровней прилипания неравновесных электронов в процессе образования центров закрепления доменных стенок в магнитном полупроводнике CdCr₂Se₄. А.А. Абдуллаев 7 796
- Особенности электронного парамагнитного резонанса в 4H-SiC в области фазового перехода изолятор—металл. II. Анализ ширины и формы линий. А.И. Вейнгер, А.Г. Забродский, Т.В. Тиснек, Е.Н. Мохов 7 816

5.5. Диэлектрические и пьезоэлектрические свойства (PACS 77)

- Легирование магнием в молекулярно-пучковой эпитаксии нитрида галлия из аммиака. А.А. Воробьев, В.В. Кораблев, С.Ю. Карпов 2 151
- Нелинейность пьезорезистивного эффекта в пленках поликристаллического кремния. В.А. Гридчин, В.М. Любимский 2 179
- Структурные дефекты на границе раздела сегнетоэлектрик—полупроводник. Л.С. Берман, И.Е. Титков 6 710

5.6. Оптические свойства полупроводников, спектроскопия, взаимодействие с различными видами излучений (PACS 78)

- Теория пороговых характеристик полупроводниковых лазеров на квантовых точках. Л.В. Асрян, Р.А. Сурис 1 3
- Резонансные переходы электрона между полупроводниковыми квантовыми точками под действием лазерного излучения. А.В. Цуканов, Л.А. Опенов . . 1 94
- О статистике и кинетике рекомбинации в полупроводниковых наноструктурах. А.В. Саченко, Ю.В. Крюченко 1 102
- Влияние примеси золота на фотолюминесценцию и фотоэде пористого кремния. Е.Ф. Венгер, С.И. Кириллова, И.М. Кизяк, Э.Г. Манойлов, В.Е. Примаченко 1 117
- Вольт-амперные характеристики монокристаллов $MnIn_2S_4$ и $MnGa_2S_4$. Н.Н. Нифтиев, О.Б. Тагиев . . 2 164
- Спектроскопия экситонных поляритонов в напряженных полупроводниковых структурах $A^{IV}B^VI$ с широкими квантовыми ямами. С.А. Марков, Р.П. Сейсян, В.А. Кособукин 2 230
- Оптические свойства поликристаллического селенида цинка. А.Н. Брызгалов, В.В. Мусатов, В.В. Бузько . 3 322
- Уширение спектральных линий в квантовых ямах при кулоновском взаимодействии носителей заряда. А.А. Афоненко 3 335
- Зависимость структурных и оптических свойств ансамблей квантовых точек в системе $InAs/GaAs$ от температуры поверхности и скорости роста. В.Г. Дубровский, Ю.Г. Мусихин, Г.Э. Цырлин, В.А. Егоров, Н.К. Поляков, Ю.Б. Самсоненко, А.А. Тонких, Н.В. Крыжановская, Н.А. Берт, В.М. Устинов 3 342
- Структурные и оптические свойства гетероструктур с квантовыми точками $InAs$ в квантовой яме $InGaAsN$, выращенных методом молекулярно-пучковой эпитаксии. И.П. Сошников, Н.В. Крыжановская, Н.Н. Леденцов, А.Ю. Егоров, В.В. Мамутин, В.А. Одноблюдов, В.М. Устинов, О.М. Горбенко, Н. Kirmse, W. Neumann, D. Bimberg 3 354
- Исследования физических явлений в полупроводниковых наноструктурах с использованием планарно-неоднородных слоев. Фотолюминесценция туннельно-связанных квантовых ям. Ю.В. Хабаров, В.В. Капаев, В.А. Петров 4 455
- Модель фотоотжига собственных дефектов гексагональных квантовых точек CdS_xSe_{1-x} . В.П. Кунец, Н.Р. Кулиш, М.П. Лисица, В.П. Брыкса 4 465
- Экситонная фотолюминесценция в легированных квази-1D структурах на основе кремния. А.В. Саченко, Д.В. Корбутяк, Ю.В. Крюченко, О.М. Сресели . 4 479
- Люминесценция ступенчатых квантовых ям в структурах $GaAs/GaAlAs$ и $InGaAs/GaAs/GaAlAs$. В.Ф. Агекян, Ю.А. Степанов, И. Акаи, Т. Карасава, Л.Е. Воробьев, Д.А. Фирсов, А.Е. Жуков, В.М. Устинов, А. Зейлмейер, С. Шмидт, С. Ханна, Е. Зибик 5 585
- Вертикальный транспорт горячих электронов в сверхрешетках $GaAs/AlAs$. Д.Н. Мирлин, В.Ф. Сапега, В.М. Устинов 5 598
- Взаимодействие инфракрасного излучения со свободными носителями заряда в мезопористом кремнии. Л.А. Осминкина, Е.В. Курепина, А.В. Павликов, В.Ю. Тимошенко, П.К. Кашкаров 5 603
- Выступ на спектрах поглощения $GaAs$, возбужденного мощными пикосекундными импульсами света. Г.С. Алтыбаев, И.Л. Броневова, С.Е. Кумеков 6 674
- Электрон-электронное рассеяние в ступенчатых квантовых ямах. В.Л. Зерова, Л.Е. Воробьев, Г.Г. Зегря 6 716
- Мощные лазеры на квантовых точках $InAs-InGaAs$ спектрального диапазона 1.5 мкм, выращенные на подложках $GaAs$. М.В. Максимов, Ю.М. Шерняков, Н.В. Крыжановская, А.Г. Гладышев, Ю.Г. Мусихин, Н.Н. Леденцов, А.Е. Жуков, А.П. Васильев, А.Р. Ковш, С.С. Михрин, Е.С. Семенова, Н.А. Малеев, Е.В. Никитина, В.М. Устинов, Ж.И. Алфёров 6 763
- Формирование электрически активных центров в кремнии, облученном электронами, в интервале температур 400–700°С. Е.П. Неустроев, С.А. Смагулова, И.В. Антонова, Л.Н. Сафронов 7 791
- Нелинейные свойства фототропных сред на основе наночастиц селенидов меди Cu_xSe в кварцевом стекле. С.А. Золотовская, Н.Н. Поснов, П.В. Прокошин, К.В. Юмашев, В.С. Гурин, А.А. Алексеенко 7 846
- Излучательная рекомбинация в пленках SiO_2 , имплантированных ионами Ge^+ и отожженных в условиях гидростатического сжатия. И.Е. Тыщенко, Л. Реболе 7 852
- Оптические и структурные свойства массивов квантовых точек $InAs$, осажденных в матрицу $In_xGa_{1-x}As$ на подложке $GaAs$. Н.В. Крыжановская, А.Г. Гладышев, С.А. Блохин, Ю.Г. Мусихин, А.Е. Жуков, М.В. Максимов, Н.Д. Захаров, А.Ф. Цацульников, Н.Н. Леденцов, P. Werner, F. Guffart, D. Bimberg . . 7 867
- Механизм сверхизлучения Дике в полупроводниковых гетероструктурах. Л.Я. Карачинский, И.И. Новиков, Н.Ю. Гордеев, Г.Г. Зегря 7 872
- Проявление квантово-размерных осцилляций времени излучательной экситонной рекомбинации в фотолюминесценции кремниевых наноструктур. А.В. Саченко, Ю.В. Крюченко, И.О. Соколовский, О.М. Сресели 7 877
- Технология получения и возможности управления характеристиками структур с квантовыми точками. В.М. Устинов 8 963
- Элементарные полосы голубого свечения нелегированных пленок нитрида галлия. А.Н. Грузинцев, А.Н. Редькин, В.И. Таций, С. Barthou, P. Benalloul . 9 1039
- Границы раздела слоев и шероховатость в многослойной кремниевой структуре. А.И. Беляева, А.А. Галуза, С.Н. Коломиец 9 1050
- Релаксация носителей заряда в квантовых точках с участием плазмон-фононных мод. А.В. Федоров, А.В. Баранов 9 1101

Лазерная генерация в гетероструктурах Cd(Zn)Se/ZnMgSSe при накачке излучением азотного и InGaN/GaN лазеров. И.В. Седова, С.В. Сорокин, А.А. Торопов, В.А. Кайгородов, С.В. Иванов, П.С. Копьев, Е.В. Луценко, В.Н. Павловский, В.З. Зубелевич, А.Л. Гурский, Г.П. Яблонский, Y. Dikme, H. Kalisch, A. Szymakowski, R.H. Jansen, B. Schineller, M. Heuken	9	1135
Влияние центров безызлучательной рекомбинации на эффективность фотолюминесценции структур с квантовыми точками. М.В. Максимов, Д.С. Сизов, А.Г. Макаров, И.Н. Каяндер, Л.В. Асрян, А.Е. Жуков, В.М. Устинов, Н.А. Черкашин, Н.А. Берт, Н.Н. Леденцов, D. Bimberg	10	1245
Волноводные Ge/Si-фотодиоды со встроенными слоями квантовых точек Ge для волоконно-оптических линий связи. А.И. Якимов, А.В. Двуреченский, В.В. Кириенко, Н.П. Степина, А.И. Никифоров, В.В. Ульянов, С.В. Чайковский, В.А. Володин, М.Д. Ефремов, М.С. Сексенбаев, Т.С. Шамирзаев, К.С. Журавлев	10	1265
Влияние адсорбции донорных и акцепторных молекул на рекомбинационные свойства кремниевых нанокристаллов. Е.А. Константинова, Ю.В. Рябчиков, Л.А. Осминкина, А.С. Воронцов, П.К. Кашкаров	11	1386
Индукцированное и спонтанное излучение структур Cd _{1-x} Hg _x Te в диапазоне 3.2–3.7 мкм при 77 К. Ю.Н. Ноздрин, А.В. Окомельков, А.П. Котков, А.Н. Моисеев, Н.Д. Гришнова	12	1419
Исследование разрыва зон на гетеропереходе напряженных короткопериодных сверхрешеток GaAs/GaAsP методом спектроскопии фотоотражения. Л.П. Авакянц, П.Ю. Боков, Т.П. Колмакова, А.В. Червяков	12	1429
Формирование и оптические свойства наночастиц CuInSe _x Te _{2(1-x)} в матрице силикатного стекла. И.В. Боднар, Н.П. Соловей, В.С. Гурин, А.П. Молочко	12	1447
Междозонное поглощение света в селективно легированных асимметричных двойных туннельно-связанных квантовых ямах. В.Л. Зерова, В.В. Капаев, Л.Е. Воробьев, Д.А. Фирсов, S. Schmidt, Е.А. Зибик, A. Seilmeier, E. Towe	12	1455
Люминесцентные свойства ZnO-микрорезонаторов цилиндрической формы. А.Н. Грузинцев, В.Т. Волков, С.В. Дубонос, М.А. Князев, Е.Е. Якимов	12	1473

5.6.1. Оптические свойства объемных материалов (PACS 78.20)

Резонансные переходы электрона между полупроводниковыми квантовыми точками под действием лазерного излучения. А.В. Цуканов, Л.А. Опенов	1	94
Оптические свойства поликристаллического селенида цинка. А.Н. Брызгалов, В.В. Мусатов, В.В. Бузько	3	322
Размерный эффект Штарка и электропоглощение в полупроводниковом сферическом слое. В.А. Арутюнян, К.С. Арамян, Г.Ш. Петросян	3	349
Фоточувствительность структур на пятикомпонентных твердых растворах изоэлектронного ряда германия. А.А. Вайполин, Ю.А. Николаев, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Теруков	4	422

Особенности теплового излучения плоскопараллельных пластин полупроводника. К.Ю. Гуга, А.Г. Коллюх, А.И. Липтуга, В.А. Мороженко, В.И. Пипа	5	524
Нелинейное поглощение света в твердых растворах Zn _{0.37} Cd _{0.63} Se. А. Байдуллаева, А.И. Власенко, П.Е. Мозоль, Л.Ф. Щербанос	5	529
Оптические свойства монокристаллов синтетических алмазов. А.В. Мудрый, Т.П. Ларионова, И.А. Шакин, Г.А. Гусаков, Г.А. Дубров, В.В. Тихонов	5	538
Обращение волнового фронта на поверхности оптически возбужденного ZnO. А.Н. Грузинцев, В.Т. Волков	5	543
Светочувствительные полиимиды, содержащие в цепи замещенные дифенилметановые фрагменты. Е.Л. Александрова, Г.И. Носова, Н.А. Соловская, К.А. Ромашкова, В.А. Лукьяшина, Е.В. Конозобко, В.В. Кудрявцев	6	678
Анализ поляризационно-модуляционных спектров индуцированного одноосным сжатием фотолюминесценции в кристалле Ge. И.Е. Матяш, Б.К. Сердега	6	684
Ультрафиолетовая люминесценция ZnO, инфильтрованного в опаловую матрицу. В.М. Масалов, Э.Н. Самаров, Г.И. Волкодав, Г.А. Емельченко, А.В. Баженов, С.И. Божко, И.А. Карпов, А.Н. Грузинцев, Е.Е. Якимов	7	884
Границы раздела слоев и шероховатость в многослойной кремниевой структуре. А.И. Беляева, А.А. Галуза, С.Н. Коломиец	9	1050
Лазерная генерация в гетероструктурах Cd(Zn)Se/ZnMgSSe при накачке излучением азотного и InGaN/GaN лазеров. И.В. Седова, С.В. Сорокин, А.А. Торопов, В.А. Кайгородов, С.В. Иванов, П.С. Копьев, Е.В. Луценко, В.Н. Павловский, В.З. Зубелевич, А.Л. Гурский, Г.П. Яблонский, Y. Dikme, H. Kalisch, A. Szymakowski, R.H. Jansen, B. Schineller, M. Heuken	9	1135
Hg _{1-x-y-z} Cd _x Mn _y Zn _z Te: новая альтернатива Hg _{1-x} Cd _x Te. И.Н. Горбатюк, А.В. Марков, С.Э. Остапов, И.М. Раренко	12	1414

5.6.2. Инфракрасная спектроскопия, комбинационное рассеяние (PACS 78.30)

Исследование структурного совершенства эпитаксиальных слоев Cd _x Hg _{1-x} Te/CdZnTe методом комбинационного рассеяния света. А.И. Белогорохов, И.А. Денисов, Н.А. Смирнова, Л.И. Белогорохова	1	84
Температурная зависимость электролюминесценции ионов Er в туннельных диодах на основе (111)-Si:(Er, O). А.М. Емельянов, Н.А. Соболев	3	361
Особенности теплового излучения плоскопараллельных пластин полупроводника. К.Ю. Гуга, А.Г. Коллюх, А.И. Липтуга, В.А. Мороженко, В.И. Пипа	5	524
Взаимодействие инфракрасного излучения со свободными носителями заряда в мезопористом кремнии. Л.А. Осминкина, Е.В. Курепина, А.В. Павликов, В.Ю. Тимошенко, П.К. Кашкаров	5	603

5.6.3. Люминесценция, излучательная рекомбинация (PACS 78.55; 78.60)

Зеленая полоса люминесценции пленок оксида цинка, легированных медью в процессе термической диффузии. Я.И. Ализов, М.В. Чукичев, В.А. Никитенко	1	34
Преобразование центров люминесценции CVD-ZnS при газостатировании. Н.К. Морозова, И.А. Каретников, В.Г. Плотниченко, Е.М. Гавришук, Э.В. Яшина, В.Б. Иконников	1	39
Влияние примесей на излучательную рекомбинацию через центры EL2 в монокристаллах арсенида галлия. М.Б. Литвинова	1	44
Влияние примеси золота на фотолюминесценцию и фотоэксцитацию пористого кремния. Е.Ф. Венгер, С.И. Кириллова, И.М. Кизяк, Э.Г. Манойлов, В.Е. Примаченко	1	117
Влияние фуллерена на фотолюминесценцию пористого кремния. О.М. Сресели, Д.Н. Горячев, Л.В. Беляков, С.П. Вуль, И.Б. Захарова, Е.А. Алексеева	1	124
Трансформация спектров фотолюминесценции слоев GaAs, сильно легированных бериллием, после гидростатического сдвигания. Т.С. Шамирзаев, К.С. Журавлев, J. Bak-Misiuk, A. Misiuk, J.Z. Domagala, J. Adamczewska	3	289
Размерный эффект Штарка и электропоглощение в полупроводниковом сферическом слое. В.А. Арутюнян, К.С. Арамян, Г.Ш. Петросян	3	349
Экситонная фотолюминесценция в легированных квази-1D структурах на основе кремния. А.В. Саченко, Д.В. Корбутяк, Ю.В. Крюченко, О.М. Сресели	4	479
Равновесные характеристики и низкотемпературная фотолюминесценция монокристаллов CdTe:Pb. А.В. Савицкий, О.А. Парфенюк, М.И. Илашук, А.И. Савчук, С.Н. Чупыра	5	516
Оптические свойства монокристаллов синтетических алмазов. А.В. Мудрый, Т.П. Ларионова, И.А. Шакин, Г.А. Гусаков, Г.А. Дубров, В.В. Тихонов	5	538
Обращение волнового фронта на поверхности оптически возбужденного ZnO. А.Н. Грузинцев, В.Т. Волков	5	543
Коэффициенты захвата свободных экситонов мелкими акцепторами и донорами в арсениде галлия. К.Д. Глинчук, Н.М. Литовченко, О.Н. Стрельчук	5	563
О предельной квантовой эффективности краевой электролюминесценции в кремниевых барьерных структурах. А.В. Саченко, А.П. Горбань, В.П. Костылев	5	570
Люминесценция ступенчатых квантовых ям в структурах GaAs/GaAlAs и InGaAs/GaAs/GaAlAs. В.Ф. Агекия, Ю.А. Степанов, И. Акаи, Т. Карасава, Л.Е. Воробьев, Д.А. Фирсов, А.Е. Жуков, В.М. Устинов, А. Зейлмейер, С. Шмидт, С. Ханна, Е. Зибик	5	585
Свойства самоорганизованных SiGe-наноструктур, полученных методом ионной имплантации. Ю.Н. Пархоменко, А.И. Белогорохов, Н.Н. Герасименко, А.В. Иржак, М.Г. Лисаченко	5	593

Фотопроводимость полимерных композиций с высокой концентрацией органических красителей. Н.А. Давиденко, А.А. Ищенко, Л.И. Костенко, Н.Г. Кувшинский, Д.Д. Мысык, Р.Д. Мысык	5	610
Кинетика электролюминесценции в эффективном кремниевом светодиоде с температурно-стабильными спектральными характеристиками. А.М. Емельянов, Ю.А. Николаев, Н.А. Соболев, Т.М. Мельникова	5	634
Длинноволновый край спектра излучения горячей электронно-дырочной плазмы в фотовозбужденном арсениде индия. Э. Шатковскис, А. Чеснис	6	670
Температурные электролюминесцентные исследования излучательных характеристик инжекционных лазеров на основе InGaAsN/GaAs. Л.Я. Карачинский, Н.Ю. Гордеев, И.И. Новиков, М.В. Максимов, А.Р. Ковш, J.S. Wang, R.S. Hsiao, J.Y. Chi, В.М. Устинов, Н.Н. Леденцов	6	757
Мощные лазеры на квантовых точках InAs-InGaAs спектрального диапазона 1.5 мкм, выращенные на подложках GaAs. М.В. Максимов, Ю.М. Шерняков, Н.В. Крыжановская, А.Г. Гладышев, Ю.Г. Мусихин, Н.Н. Леденцов, А.Е. Жуков, А.П. Васильев, А.Р. Ковш, С.С. Михрин, Е.С. Семенова, Н.А. Малеев, Е.В. Никитина, В.М. Устинов, Ж.И. Алфёров	6	763
Пьезоспектроскопическое исследование полосы излучения с максимумом около 1.2 эВ в n-GaAs:S. А.А. Гуткин, М.А. Рещиков	7	825
Излучательная рекомбинация в пленках SiO ₂ , имплантированных ионами Ge ⁺ и отожженных в условиях гидростатического сжатия. И.Е. Тыщенко, Л. Реболе	7	852
Проявление квантово-размерных осцилляций времени излучательной экситонной рекомбинации в фотолюминесценции кремниевых наноструктур. А.В. Саченко, Ю.В. Крюченко, И.О. Соколовский, О.М. Сресели	7	877
Ультрафиолетовая люминесценция ZnO, инфильтрованного в опаловую матрицу. В.М. Масалов, Э.Н. Самаров, Г.И. Волкодав, Г.А. Емельченко, А.В. Баженов, С.И. Божко, И.А. Карпов, А.Н. Грузинцев, Е.Е. Якимов	7	884
Влияние вакуумного отжига на краевую люминесценцию нелегированного селенида цинка. В.П. Махний, А.М. Слетов, И.В. Ткаченко	9	1034
Элементарные полосы голубого свечения нелегированных пленок нитрида галлия. А.Н. Грузинцев, А.Н. Редькин, В.И. Таший, С. Barthou, P. Benalloul	9	1039
Влияние супрамолекулярного упорядочения на фотофизические свойства полиамидинов. Е.Л. Александрова, М.Е. Компан, М.М. Дудкина, А.В. Теньковцев, Е.И. Теруков	9	1110
Кварцевые микротрубки на основе макропористого кремния. Е.В. Астрова, Т.Н. Боровинская, Т.С. Перова, М.В. Загорянская	9	1121
Формирование и исследование захороненных слоев SiC с высоким содержанием радиационных дефектов. Е.В. Богданова, В.В. Козловский, Д.С. Румянцев, А.А. Волкова, А.А. Лебедев	10	1211

- Оптические и электрические свойства 4H-SiC, облученного нейтронами и тяжелыми ионами высоких энергий.** *Е.В. Калинина, Г.Ф. Холуянов, Г.А. Онушкин, Д.В. Давыдов, А.М. Стрельчук, А.О. Константинов, А. Hallén, А.Ю. Никифоров, В.А. Скуратов, К. Navarcsak* 10 1223
- Примесные центры редкоземельных ионов (Eu, Sm, Er) в вюрцитных кристаллах GaN.** *В.В. Криволапчук, Ю.В. Кожанова, В.В. Лундин, М.М. Мездрогина, С.Н. Родин, Ш.А. Юсупова* 11 1308
- Влияние протонного облучения на кинетику затухания фосфоресценции керамики ZnS—Cu.** *Т.А. Кучакова, Г.В. Весна, В.А. Макара* 11 1316
- Индucedированное и спонтанное излучение структур Cd_xHg_{1-x}Te в диапазоне 3.2–3.7 мкм при 77 К.** *Ю.Н. Ноздрин, А.В. Окомельков, А.П. Котков, А.Н. Моисеев, Н.Д. Гришнова* 12 1419
- Фотолюминесценция электронно-дырочной плазмы в полужолирующем нелегированном GaAs.** *В.Ф. Коваленко, С.В. Шутов* 12 1423
- Люминесцентные свойства ZnO-микрорезонаторов цилиндрической формы.** *А.Н. Грузинцев, В.Т. Волков, С.В. Дубонос, М.А. Князев, Е.Е. Якимов* 12 1473
- 5.6.4. Оптические свойства тонких пленок, поверхностей и структур, содержащих границы раздела (сверхрешетки, гетеропереходы и т. п.) (PACS 78.66)**
- Формирование пленок нанокристаллического кремния имплантацией больших доз ионов Н⁺ в слои кремния на изоляторе и последующим быстрым термическим отжигом.** *И.Е. Тысченко, В.П. Попов, А.Б. Талочкин, А.К. Гутаковский, К.С. Журавлев* . . 1 111
- Осцилляции наведенного фотоэффекта в гетеропереходах ZnO/GaAs.** *С.Е. Никитин, Ю.А. Николаев, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Теруков, N. Fernelius, J. Goldstein* 4 407
- Фоточувствительность структур на пятикомпонентных твердых растворах изоэлектронного ряда германия.** *А.А. Вайполин, Ю.А. Николаев, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Теруков* 4 422
- Особенности теплового излучения плоскопараллельных пластин полупроводника.** *К.Ю. Гуга, А.Г. Коллюх, А.И. Липтуга, В.А. Мороженко, В.И. Пиша* 5 524
- Взаимодействие инфракрасного излучения со свободными носителями заряда в мезопористом кремнии.** *Л.А. Осминкина, Е.В. Курепина, А.В. Павликов, В.Ю. Тимошенко, П.К. Кашкаров* 5 603
- Фотопроводимость полимерных композиций с высокой концентрацией органических красителей.** *Н.А. Давиденко, А.А. Ищенко, Л.И. Костенко, Н.Г. Кувшинский, Д.Д. Мысык, Р.Д. Мысык* 5 610
- Ультрафиолетовая люминесценция ZnO, инфильтрованного в опаловую матрицу.** *В.М. Масалов, Э.Н. Самаров, Г.И. Волкодав, Г.А. Емельяченко, А.В. Баженов, С.И. Божко, И.А. Карпов, А.Н. Грузинцев, Е.Е. Якимов* 7 884
- Границы раздела слоев и шероховатость в многослойной кремниевой структуре.** *А.И. Беляева, А.А. Галуза, С.Н. Коломиец* 9 1050
- Фотоувствительные структуры на основе монокристаллического кремния и пленок фталоцианина CuPc. Получение и свойства.** *Г.А. Ильчук, Н.В. Климова, О.И. Коньков, С.Е. Никитин, Ю.А. Николаев, Л.И. Рудая, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Теруков, В.В. Шаманин, Т.А. Юрре* 9 1056
- Светочувствительные полимерные полупроводники.** *Е.Л. Александрова* 10 1153
- Светочувствительные свойства тонких полупроводниковых пленок нанокompозитов на основе металлоорганических комплексов Cu⁺ и Ru²⁺.** *Е.Л. Александрова, Н.Н. Химич* 11 1321
- Механизм фотогенерации носителей заряда в полиамидиновых супрамолекулярных структурах.** *Е.Л. Александрова, М.М. Дудкина, А.В. Теньковцев* 11 1325
- Фотоэлектрические свойства структур ZnO/CuPc/Si.** *Г.А. Ильчук, С.Е. Никитин, Ю.А. Николаев, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Теруков* 11 1349
- Формирование и оптические свойства наночастиц CuInSe_{2x}Te_{2(1-x)} в матрице силикатного стекла.** *И.В. Боднар, Н.П. Соловей, В.С. Гурич, А.П. Молочко* 12 1447
- 5.7. Эмиссия электронов и ионов. Ударная ионизация (PACS 79)**
- Адсорбция сольватированных гидросульфид-ионов на поверхность GaAs(100): роль растворителя при модификации структуры поверхности.** *М.В. Лебедев, Th. Mayer, W. Jaegermann* 2 156
- Светочувствительные полимерные полупроводники.** *Е.Л. Александрова* 10 1153
- Светочувствительные свойства тонких полупроводниковых пленок нанокompозитов на основе металлоорганических комплексов Cu⁺ и Ru²⁺.** *Е.Л. Александрова, Н.Н. Химич* 11 1321
- 6. Технология, материаловедение, применение полупроводников (PACS 80)**
- 6.1. Методы получения и обработки полупроводниковых материалов (PACS 81; 82)**
- Преобразование центров люминесценции CVD-ZnS при газостатировании.** *Н.К. Морозова, И.А. Каретников, В.Г. Плотноченко, Е.М. Гавришук, Э.В. Яшина, В.Б. Иконников* 1 39
- Влияние водорода на электронную структуру и свойства нитрида бора.** *С.Е. Кулькова, Д.В. Чудинов, Д.В. Ханин* 1 61
- Диффузия цинка в незащищенную поверхность InP.** *В.Ф. Андриевский, Е.В. Гушинская, С.А. Малышев* 1 68

- Формирование омических контактов к полупроводящему GaAs путем лазерного осаждения In.** В. Казлаускаене, В. Кажукаускас, Ю. Мишкинис, А. Петравичюс, Р. Пукас, С. Сакалаускас, Ю. Синюс, Ю.-В. Вайткус, А. Жиндулис 1 79
- Влияние фуллерена на фотолюминесценцию пористого кремния.** О.М. Сресели, Д.Н. Горячев, Л.В. Беляков, С.П. Вуль, И.Б. Захарова, Е.А. Алексеева . . . 1 124
- Легирование магнием в молекулярно-пучковой эпитаксии нитрида галлия из аммиака.** А.А. Воробьев, В.В. Кораблев, С.Ю. Карпов 2 151
- Простая модель для расчета скорости роста эпитаксиальных слоев карбида кремния в вакууме.** С.Ю. Давыдов, А.А. Лебедев, Н.С. Савкина, М. Syvajarvi, R. Yakimova 2 153
- Магнитные свойства теллурида кадмия, легированного германием.** Ю.В. Шалдин, И. Вархульска, Ю.М. Иванов 2 172
- Структуры на основе полупроводниковых соединений Cu(Ag)In_nS_m.** И.В. Боднар, В.А. Полубок, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, М.С. Сергинов 2 202
- Энергетическая структура A⁺-центров в квантовых ямах.** Н.С. Аверкиев, А.Е. Жуков, Ю.Л. Иванов, П.В. Петров, К.С. Романов, А.А. Тонких, В.М. Устинов, Г.Э. Цырлин 2 222
- Исследование образования и модификации нанокристаллических включений кремния в пленках a-Si:H методом просвечивающей электронной микроскопии.** В.П. Афанасьев, А.С. Гудовских, А.З. Казак-Казакевич, А.П. Сазанов, И.Н. Трапезникова, Е.И. Теруков 2 226
- Генезис наноразмерных дефектов и разрушений в GaAs при многократном квазистатическом фотодеформировании микронных областей полупроводника.** С.В. Винценц, А.В. Зайцева, В.Б. Зайцев, Г.С. Плотноков 3 257
- Влияние предварительного легирования и режимов имплантации на диффузию кремния в GaAs при радиационном отжиге.** М.В. Ардышев, В.М. Ардышев, Ю.Ю. Крючков 3 265
- Диффузия хрома в арсениде галлия.** С.С. Хлудков, О.Б. Корещкая, А.В. Тяжев 3 274
- Трансформация спектров фотолюминесценции слоев GaAs, сильно легированных бериллием, после гидростатического сдавливания.** Т.С. Шамирзаев, К.С. Журавлев, J. Bak-Misiuk, A. Misiuk, J.Z. Domagala, J. Adamczewska 3 289
- Низкотемпературная релаксация упругих напряжений в SiGe/Si-гетероструктурах, облученных ионами Ge⁺.** В.С. Аврутин, Ю.А. Агафонов, А.Ф. Вяткин, В.И. Зиненко, Н.Ф. Изюмская, Д.В. Иржак, Д.В. Рошупкин, Э.А. Штейнман, В.И. Вдовин, Т.Г. Югова 3 325
- Зависимость структурных и оптических свойств ансамблей квантовых точек в системе InAs/GaAs от температуры поверхности и скорости роста.** В.Г. Дубровский, Ю.Г. Мусихин, Г.Э. Цырлин, В.А. Егоров, Н.К. Поляков, Ю.Б. Самсоненко, А.А. Тонких, Н.В. Крыжановская, Н.А. Берг, В.М. Устинов 3 342
- Структурные и оптические свойства гетероструктур с квантовыми точками InAs в квантовой яме InGaAsN, выращенных методом молекулярно-пучковой эпитаксии.** И.П. Сошников, Н.В. Крыжановская, Н.Н. Леденцов, А.Ю. Егоров, В.В. Мамутин, В.А. Одноблюдов, В.М. Устинов, О.М. Горбенко, H. Kirmse, W. Neumann, D. Bimberg 3 354
- Фотоэлементы на основе гетероструктур GaAs/Ge, полученные комбинацией методов МОСГФЭ и диффузии цинка.** В.М. Андреев, В.П. Хвостиков, Н.А. Калюжный, С.С. Титков, О.А. Хвостикова, М.З. Шварц 3 369
- Закономерности влияния примесей на предел текучести кристаллов кремния.** Б.В. Петухов 4 385
- Электротранспортные процессы в монокристаллах антимонида галлия с участием расплавленных включений GaSb-Sn.** А.М. Орлов, А.А. Скворцов, А.А. Саланов 4 391
- Исследования физических явлений в полупроводниковых наноструктурах с использованием планарно-неоднородных слоев.** Фотолюминесценция туннельно-связанных квантовых ям. Ю.В. Хабаров, В.В. Капась, В.А. Петров 4 455
- Определение профиля распределения концентрации носителей заряда в слабосвязанных сверхрешетках GaAs/AlGaAs.** П.Н. Брунков, С.О. Усов, Ю.Г. Мусихин, А.Е. Жуков, Г.Э. Цырлин, В.М. Устинов, С.Г. Кошкин, Г.К. Расулова 4 469
- Взаимосвязь спиновых структурных дефектов и проводимости в пленках гидрированного нанокристаллического кремния с добавками углерода.** О.И. Шевалевский, А.А. Цветков, Л.Л. Ларина, S.Y. Myong, K.S. Lim 5 547
- Выращивание и легирование магнием слоев InAs методом газовой эпитаксии из металлорганических соединений.** Т.И. Воронина, Т.С. Лагунова, С.С. Кижасев, С.С. Молчанов, Б.В. Пушный, Ю.П. Яковлев 5 556
- Свойства самоорганизованных SiGe-наноструктур, полученных методом ионной имплантации.** Ю.Н. Пархоменко, А.И. Белогорохов, Н.Н. Герасименко, А.В. Иржак, М.Г. Лисаченко 5 593
- Тензорезистивный эффект в слоях пористого кремния с различной морфологией.** С.П. Зимин, А.Н. Брагин 5 616
- Особенности электрического транспорта в анизотропно наноструктурированном кремнии.** П.А. Форш, Л.А. Осминкина, В.Ю. Тимошенко, П.К. Кашкаров 5 626
- Низкопороговые инжекционные лазеры на основе одиночных квантовых ям InGaAsN, работающие в диапазоне длин волн 1.3 мкм.** В.А. Одноблюдов, А.Ю. Егоров, М.М. Кулагина, Н.А. Малеев, Ю.М. Шерняков, Е.В. Никитина, В.М. Устинов . . . 5 630
- Магнитные свойства углеродных структур.** Т.Л. Макарова 6 641
- Исследование физических механизмов лазерной коррекции и стабилизации параметров структур Al-n-n⁺-Si-Al с барьером Шоттки.** Г.И. Воробец, М.М. Воробец, В.Н. Стребежев, Е.В. Бузанева, А.Г. Шкавро 6 690

- Формирование толстых слоев пористого кремния при недостаточной концентрации неосновных носителей. Д.Н. Горячев, Л.В. Беляков, О.М. Сресели 6 739
- Явление гистерезиса в Ag_2Te вблизи и в области фазового превращения. С.А. Алиев 7 830
- Нелинейные свойства фототропных сред на основе наночастиц селенидов меди Cu_xSe в кварцевом стекле. С.А. Золотовская, Н.Н. Поснов, П.В. Прокошин, К.В. Юмашев, В.С. Гурин, А.А. Алексеенко 7 846
- Оптические и структурные свойства массивов квантовых точек InAs , осажденных в матрицу $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ на подложке GaAs . Н.В. Крыжановская, А.Г. Гладышев, С.А. Блохин, Ю.Г. Мусихин, А.Е. Жуков, М.В. Максимов, Н.Д. Захаров, А.Ф. Цацульников, Н.Н. Леденцов, Р. Werner, F. Guffart, D. Bimberg . . . 7 867
- Ультрафиолетовая люминесценция ZnO , инфильтрованного в опаловую матрицу. В.М. Масалов, Э.Н. Самаров, Г.И. Волкодав, Г.А. Емельченко, А.В. Баженов, С.И. Божко, И.А. Карпов, А.Н. Грузинцев, Е.Е. Якимов 7 884
- Molecular based concepts in PV towards full spectrum utilization. J.A.M. van Roosmalen 8 1007
- Влияние вакуумного отжига на краевую люминесценцию нелегированного селенида цинка. В.П. Махний, А.М. Слетов, И.В. Ткаченко 9 1034
- Взаимодействие молекул C_{60} с поверхностью (100)W — адсорбция, начальные стадии роста пленок и термическая трансформация адсорбционного слоя. Н.Р. Галль, Е.В. Рутьков, А.Я. Тонтегоде 9 1061
- Формирование потенциальных барьеров на контакте металл–полупроводник с использованием метода селективного удаления атомов. Б.А. Гурович, Б.А. Аронзон, В.В. Рыльков, Е.Д. Ольшанский, Е.А. Кулешова, Д.И. Долгий, Д.Ю. Ковалев, В.И. Филиппов 9 1074
- Особенности отжига радиационных дефектов в кремниевых $p-n$ -структурах: роль примесных атомов железа. Б.А. Комаров 9 1079
- Влияние супрамолекулярного упорядочения на фотофизические свойства полиамидинов. Е.Л. Александрова, М.Е. Компан, М.М. Дудкина, А.В. Теньковцев, Е.И. Теруков 9 1110
- Дрейфовая подвижность носителей заряда в пористом карбиде кремния. Л.П. Казакова, М.Г. Мынбаева, К.Д. Мынбаев 9 1118
- Кварцевые микротрубки на основе макропористого кремния. Е.В. Астрова, Т.Н. Боровинская, Т.С. Перова, М.В. Загорянская 9 1121
- Технология создания рисунка в макропористом кремнии и получение полос двумерных фотонных кристаллов с вертикальными стенками. Е.В. Астрова, Т.Н. Боровинская, В.А. Толмачев, Т.С. Перова . . 9 1125
- Электронные и структурные переходы в сплавах $\text{Pb}_{1-x}\text{Ge}_x\text{Te}$:Ga под давлением. Е.П. Скипетров, Е.А. Зверева, О.С. Волкова, А.В. Голубев, А.Ю. Моллаев, Р.К. Арсланов, В.Е. Слынько 10 1199
- Исследование зависимостей проводимости и коэффициента Холла от магнитного поля в пленках $\text{Cd}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}$, выращенных методом молекулярно-лучевой эпитаксии. П.А. Бахтин, С.А. Дворецкий, В.С. Варавин, А.П. Коробкин, Н.Н. Михайлов, Ю.Г. Сидоров 10 1203
- Влияние низкотемпературного отжига на электрофизические параметры пленок $n\text{-CdHgTe}$. П.А. Бахтин, С.А. Дворецкий, В.С. Варавин, А.П. Коробкин, Н.Н. Михайлов, И.В. Сабинаина, Ю.Г. Сидоров . . . 10 1207
- Влияние давления и водорода на образование вакансий и дивакансий в кристаллическом кремнии. В.Г. Заводинский, А.А. Гниденко, А. Мисюк, Я. Бак-Мисюк 11 1281
- Механизм низкотемпературных стимулированных процессов плазменного анодирования металлов и полупроводников. А.П. Бибилашвили, А.Б. Герасимов 11 1304
- Влияние γ -облучения на характеристики границы раздела кремний–свинцово-боросиликатное стекло. П.Б. Парчинский, С.И. Власов, А.А. Насиров 11 1345
- Гетероструктуры AlGaIn/GaN с высокой подвижностью электронов, выращенные методом газовой эпитаксии из металлорганических соединений. В.В. Лундин, Е.Е. Заварин, А.И. Бесюлькин, А.Г. Гладышев, А.В. Сахаров, М.Ф. Кокорев, Н.М. Шмидт, А.Ф. Цацульников, Н.Н. Леденцов, Ж.И. Алфёров, Р. Каканаков 11 1364
- Формирование двумерных и одномерных твердофазных квантовых наноструктур в системе CdHgTe –электролит. В.Б. Божевольнов, А.М. Яфясов, П.П. Коноров 11 1374
- Влияние адсорбции донорных и акцепторных молекул на рекомбинационные свойства кремниевых нанокристаллов. Е.А. Константинова, Ю.В. Рябчиков, Л.А. Осминкина, А.С. Воронцов, П.К. Кашкаров 11 1386
- Формирование и оптические свойства наночастиц $\text{CuInSe}_2\text{Te}_{2(1-x)}$ в матрице силикатного стекла. И.В. Боднарь, Н.П. Соловей, В.С. Гурин, А.П. Молочко 12 1447
- Распределение по размерам нанокластеров кобальта в матрице аморфного углерода. В.И. Иванов-Омский, А.В. Колобов, А.Б. Лодыгин, С.Г. Ястребов 12 1463
- Инфракрасные светодиоды на основе твердых растворов GaInAsSb , выращенных из содержащих свинец растворов–расплавов. А.П. Астахова, Е.А. Гребенщикова, Э.В. Иванов, А.Н. Именков, Е.В. Куницына, Я.А. Пархоменко, Ю.П. Яковлев . . 12 1466

6.2. Полупроводниковые приборы (PACS 84; 85)

- Сверхскоростной электронный дрейф в полевых полупроводниковых структурах с секционированным каналом. В.А. Гергель, Ю.В. Гуляев, А.П. Зеленый, М.Н. Якупов 2 237

- Экспериментальное исследование $p-i-n$ -диодов на основе SiC в 3-сантиметровом диапазоне. К.В. Василевский, П.Б. Гамулецкая, А.В. Кириллов, А.А. Лебедев, Л.П. Романов, В.А. Смирнов 2 242
- Влияние предварительного легирования и режимов имплантации на диффузию кремния в GaAs при радиационном отжиге. М.В. Ардышев, В.М. Ардышев, Ю.Ю. Крючков 3 265
- Трансформация спектров фотолюминесценции слоев GaAs, сильно легированных бериллием, после гидростатического сдавливания. Т.С. Шамирзаев, К.С. Журавлев, J. Bak-Misiuk, A. Misiuk, J.Z. Domagala, J. Adamczewska 3 289
- Импеданс твердых растворов на основе теллурида свинца, легированного галлием. Б.А. Акимов, В.В. Прядун, Л.И. Рябова, Д.Р. Хохлов 3 293
- Низкотемпературная релаксация упругих напряжений в SiGe/Si-гетероструктурах, облученных ионами Ge⁺. В.С. Аврутин, Ю.А. Агафонов, А.Ф. Вяткин, В.И. Зиненко, Н.Ф. Изюмская, Д.В. Иржак, Д.В. Рошупкин, Э.А. Штейнман, В.И. Вдовин, Т.Г. Югова 3 325
- Температурная зависимость электролюминесценции ионов Er в туннельных диодах на основе (111)-Si:(Er, O). А.М. Емельянов, Н.А. Соболев 3 361
- Фотоэлементы на основе гетероструктур GaAs/Ge, полученные комбинацией методов МОСГФЭ и диффузии цинка. В.М. Андреев, В.П. Хвостиков, Н.А. Калужный, С.С. Титков, О.А. Хвостикова, М.З. Шварц 3 369
- Исследование характеристик фотодиодных линеек на InSb. П.В. Бирюлин, В.И. Туринов, Е.Б. Якимов 4 498
- Тепловой расчет pin -диодов на основе карбида кремния. П.Б. Гамулецкая, А.В. Кириллов, А.А. Лебедев, Л.П. Романов, В.А. Смирнов 4 504
- Изменение контактной разности потенциалов фотодиода на основе гетероперехода n -InSe- p -GaSe в процессе „старения“. С.И. Драпак, В.Б. Орлецкий, З.Д. Ковалюк 5 566
- Кинетика электролюминесценции в эффективном кремниевом светодиоде с температурно-стабильными спектральными характеристиками. А.М. Емельянов, Ю.А. Николаев, Н.А. Соболев, Т.М. Мельникова 5 634
- Трансформация коротковолновой полосы излучения двухзарядного природного акцептора в длинноволновую в светодиодах на основе GaSb. Е.А. Гребенщикова, А.Н. Именков, Б.Е. Журтанов, Т.Н. Данилова, М.А. Сиповская, Н.В. Власенко, Ю.П. Яковлев 6 745
- Мягкий пробой как причина спада тока в туннельной МОП структуре. А.Ф. Шулекин, С.Э. Тягинов, R. Khilil, A. El Hdiy, М.И. Векслер 6 753
- Межфазные взаимодействия и особенности структурной релаксации в контактах TiB_x- n -GaAs (InP, GaP, 6H-SiC), подвергнутых активным обработкам. Н.С. Болтовец, В.Н. Иванов, Р.В. Конакова, Я.Я. Кудрик, О.С. Литвин, П.М. Литвин, В.В. Миленин 7 769
- Устойчивость обработанных протонами GaAs фотодетекторов к гамма-нейтронному облучению. А.В. Мурель, С.В. Оболенский, А.Г. Фефелов, Е.В. Киселева 7 834
- Радиационная стойкость SiC-детекторов транзисторного и диодного типов при облучении протонами 8 МэВ. Н.Б. Строкан, А.М. Иванов, Н.С. Савкина, А.А. Лебедев, В.В. Козловский, M. Syvajarvi, R. Yakimova 7 841
- Исследование утечек по поверхности фотодиодов на CdHgTe. П.В. Бирюлин, В.И. Туринов, Е.Б. Якимов 7 890
- Тенденции и перспективы развития солнечной фотоэнергетики. Ж.И. Алфёров, В.М. Андреев, В.Д. Румянцев 8 937
- Quantum dot solar concentrators. A.J. Chatten, K.W.J. Barnham, B.F. Buxton, N.J. Ekins-Daukes, M.A. Malik 8 949
- Key aspects in the modeling of concentrator III-V solar cells and III-V thermophotovoltaic converters. Carlos Algora 8 958
- Технология получения и возможности управления характеристиками структур с квантовыми точками. В.М. Устинов 8 963
- Next-Generation Technologies in the USA. R. McConnell 8 971
- FULLSPECTRUM: A new PV wave of more efficient use of solar spectrum. A. Luque, A. Martí 8 975
- Practical thermophotovoltaic generators. B. Bitnar, W. Durisch, G. Palfinger, F. von Roth, U. Vogt, A. Brönstrup, D. Seiler 8 980
- Intermediate band solar cells: comparison with Shockley-Read-Hall recombination. A. Martí, L. Cuadra, N. López, A. Luque 8 985
- Термофотоэлектрические преобразователи теплового и концентрированного солнечного излучения. В.П. Хвостиков, О.А. Хвостикова, П.Ю. Газарян, М.З. Шварц, В.Д. Румянцев, В.М. Андреев 8 988
- Japan programs on novel concepts in PV. Masafumi Yamaguchi, Tatsuya Takamoto, Kenji Araki, Mitsuru Imaizumi 8 994
- Modeling improvement of spectral response of solar cells by deployment of spectral converters containing semiconductor nanocrystals. W.G.J.H.M. van Sark, A. Meijerink, R.E.I. Schropp, J.A.M. van Roosmalen, E.H. Lysen 8 1000
- Molecular based concepts in PV towards full spectrum utilization. J.A.M. van Roosmalen 8 1007
- Излучательная рекомбинация в кремниевой туннельной МОП структуре. N. Asli, М.И. Векслер, И.В. Грехов, P. Seegebrecht, С.Э. Тягинов, А.Ф. Шулекин 9 1068
- Токовая неустойчивость с S-образной вольт-амперной характеристикой в слоях металл-полимерного комплекса полиамидокислоты с Tb⁺². Э.А. Лебедев, М.Я. Гойхман, К.Д. Цэндин, И.В. Подешво, Е.И. Теруков, В.В. Кудрявцев 9 1115
- Исследование глубоких уровней в CdHgTe методом туннельного тока фотодиодов. В.И. Туринов 9 1129

- Характеристики планарных диодов терагерцового диапазона частот на основе сильно легированных GaAs/AlAs-сверхрешеток. Д.Г. Павельев, Н.В. Демарина, Ю.И. Кошуринов, А.П. Васильев, Е.С. Семенова, А.Е. Жуков, В.М. Устинов 9 1141
- Определение профиля диффузии кислорода в поликристаллических слоях селенида свинца методами ядерного микроанализа. А.Е. Гамарц, В.М. Лебедев, В.А. Мошников, Д.Б. Чеснокова 10 1195
- Волноводные Ge/Si-фотодиоды со встроенными слоями квантовых точек Ge для волоконно-оптических линий связи. А.И. Якимов, А.В. Двуреченский, В.В. Кириенко, Н.П. Степина, А.И. Никифоров, В.В. Ульянов, С.В. Чайковский, В.А. Володин, М.Д. Ефремов, М.С. Сексенбаев, Т.С. Шамирзаев, К.С. Журавлев 10 1265
- Светодиоды на основе InAs с резонатором, сформированным анодным контактом и границей раздела полупроводник/воздух. Н.В. Зотова, Н.Д. Ильинская, С.А. Карандашев, Б.А. Матвеев, М.А. Ременный, Н.М. Стусь, В.В. Шустов 10 1270
- Сверхвысокочастотные полевые транзисторы на основе нитридов III группы. С.Б. Александров, Д.А. Баранов, А.П. Кайдаш, Д.М. Красовицкий, М.В. Павленко, С.И. Петров, Ю.В. Погорельский, И.А. Соколов, М.В. Степанов, В.П. Чалый, Н.Б. Гладышева, А.А. Дорофеев, Ю.А. Матвеев, А.А. Чернявский 10 1275
- К эффекту больших доз при ионной имплантации кремния. Д.И. Тетельбаум, А.И. Герасимов 11 1301
- Нелинейное преобразование частоты в лазере с двойным вертикальным резонатором. Ю.А. Морозов, И.С. Нефедов, В.Я. Алешкин 11 1392
- Свойства светодиодов на основе GaSb с сетчатыми омическими контактами. А.Н. Именков, Е.А. Гребенщикова, Б.Е. Журтанов, Т.Н. Данилова, М.А. Сиповская, Н.В. Власенко, Ю.П. Яковлев . . . 11 1399
- Инфракрасные светодиоды на основе твердых растворов GaInAsSb, выращенных из содержащих свинец растворов-расплавов. А.П. Астахова, Е.А. Гребенщикова, Э.В. Иванов, А.Н. Именков, Е.В. Куницына, Я.А. Пархоменко, Ю.П. Яковлев . . 12 1466
- Сверхнизкие внутренние оптические потери в квантово-размерных лазерных гетероструктурах раздельного ограничения. С.О. Слипченко, Д.А. Винокуров, Н.А. Пихтин, З.Н. Соколова, А.Л. Станкевич, И.С. Тарасов, Ж.И. Алфёров 12 1477